OFE03500.017376.

PATENT APPLICATION

HOV 2 5 2003 PER TRADEMARK

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)	
		:	Examiner: Not Yet Assigned
MASAHIKO KUBOTA ET AL.)	
		:	Group Art Unit: 2853
Application No.: 10/615,305)	·
		:	
Filed: July 9, 2003)	
		:	
For:	METHOD OF MANUFACTURING	3)	
	MICROSTRUCTURE, METHOD	:	
	OF MANUFACTURING LIQUID)	
	DISCHARGE HEAD, AND	:	
	LIQUID DISCHARGE HEAD)	November 24, 2003

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Sir:

In support of Applicants' claim for priority under 35 U.S.C. § 119, enclosed is a certified copy of the following foreign application:

2002-201805, filed July 10, 2002.

Applicants' undersigned attorney may be reached in our New York office by telephone at (212) 218-2100. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,

Attorney for Applicants

Registration No. 47,138

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO 30 Rockefeller Plaza New York, New York 10112-3800 Facsimile: (212) 218-2200

NY_MAIN 390011v1



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

18

2002年 7月10日

出 願 番 号 Application Number:

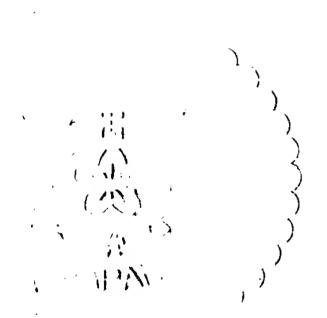
特願2002-201805

[ST. 10/C]:

[JP2002-201805]

出 願 人
Applicant(s):

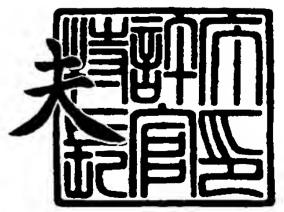
キヤノン株式会社



2003年 7月29日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

4686019

【提出日】

平成14年 7月10日

【あて先】

特許庁長官

【国際特許分類】

B41J 2/16

殿

【発明の名称】

微細構造体の製造方法、液体吐出ヘッドの製造方法およ

び液体吐出ヘッド

【請求項の数】

11

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

久保田 雅彦

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

檜山 亘

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【氏名又は名称】

キヤノン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100088328

【弁理士】

【氏名又は名称】

金田 暢之

【電話番号】

03-3585-1882

【選任した代理人】

【識別番号】

100106297

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 克博

ページ: 2/E

【選任した代理人】

【識別番号】

100106138

【弁理士】

【氏名又は名称】 石橋

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 (

089681

【納付金額】

21,000円

政幸

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面]

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 微細構造体の製造方法、液体吐出ヘッドの製造方法および液 体吐出ヘッド

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、熱架橋したポジ型感光性材料層(第1のポジ型感 光材料層)を形成し、その上に、感光波長域が第1のポジ型感光材料層と異なる 第2のポジ型感光性材料層を形成し、まず、第2のポジ型感光性材料層の所望の 領域のみを分解反応させた後現像し、該第2のポジ型感光性材料層にパターンを 形成した後、第1のポジ型感光性材料層の所定の領域を分解反応させた後現像し 、前記第1のポジ型感光性材料層にパターンを形成する、ポジ型感光材料層の上 と下のパターンを異ならせる微細構造体の製造において、

第1のポジ型感光材料がメタクリル酸エステルを主成分し、熱架橋因子として メタクリル酸を含むメタクリル系共重合体組成物とする電離放射線分解型ポジレ ジストであり、メタクリル酸単位が2~30重量%かつ共重合体の分子量が50 00~50000であり、

第2のポジ型感光性材料層が、ポリメチルイソプロペニルケトンを主成分とす る電離放射線分解型ポジレジストである

ことを特徴とする微細構造体の製造方法。

【請求項2】 前記メタクリル系共重合体組成物が、ラジカル重合により形 成されたものである請求項1に記載の微細構造体の製造方法。

【請求項3】 第1のポジ型感光性材料層における熱架橋が脱水反応により 形成される請求項2または3に記載の微細構造体の製造方法。

【請求項4】 液体吐出エネルギー発生素子を形成した基板上の液流路形成 部分に除去可能な樹脂にて型パターンを形成し、該型パターンを被覆するように 前記基板上に被覆樹脂層を塗布し硬化させた後、前記型パターンを溶解除去して 液流路を形成する、液体吐出ヘッドの製造方法において、

前記型パターンを形成する工程が、基板上に、熱架橋反応を用いて熱架橋した ポジ型感光性材料層(第1のポジ型感光材料層)を形成する工程、該第1のポジ 型感光性材料層の上に、感光波長域が第1のポジ型感光材料層と異なる第2のポ

ジ型感光性材料層を形成する工程、2層のポジ型感光性材料層が形成された基板 面に第2のポジ型感光性材料に感光する電離放射線により前記第2のポジ型感光 性材料層の所望の領域のみを分解反応させた後、現像し、該第2のポジ型感光性 材料層に所望のパターンを形成する工程、および、第2のポジ型感光性材料層上 に所望のパターンが形成された基板面に、第1ポジ型感光材料層が感光する電離 放射線で第1のポジ型感光性材料層の所定の領域を分解反応させた後、現像し、 前記第1のポジ型感光性材料層に所望のパターンを形成する工程を順次含み、

第1のポジ型感光材料がメタクリル酸エステルを主成分し、熱架橋因子として メタクリル酸を含むメタクリル系共重合体組成物とする電離放射線分解型ポジレ ジストであり、メタクリル酸単位が2~30重量%かつ共重合体の分子量が50 00~50000であり、

第2のポジ型感光性材料層が、ポリメチルイソプロペニルケトンを主成分とす る電離放射線分解型ポジレジストである

ことを特徴とする液体吐出ヘッドの製造方法。

【請求項5】 液体吐出エネルギー発生素子を形成した基板上の液流路形成 部分に除去可能な樹脂にて型パターンを形成し、該型パターンを被覆するように 前記基板上に被覆樹脂層を塗布し硬化させた後、前記型パターンを溶解除去して 液流路を形成する、液体吐出ヘッドの製造において、

前記型パターンを溶解除去する工程では、ネガ型感光性被覆樹脂膜を塗布し、 前記液流路に連通する吐出孔を含むパターンを露光した後、現像して吐出孔部分 を形成し、ついでポジレジスト膜の両方が分解反応する波長域の電離放射線を照 射して、電離放射線分解型ポジレジスト膜からなるレジストパターンを分解し、 基板を有機溶剤に浸漬し、該ポジレジストのレジストパターンを溶解、除去する

ことを特徴とする液体吐出ヘッドの製造方法。

【請求項6】 請求項4または5に記載の製造方法で得られた液体吐出ヘッ ド。

【請求項7】 液流路にごみ捕捉用の柱状部材が該液流路を構成する材料よ り形成されている請求項6に記載の液体吐出ヘッド。

3/

【請求項8】 液流路にごみ捕捉用の柱状部材が、前記基板に到達していない請求項7に記載の液体吐出ヘッド。

【請求項9】 前記基板に前記液流路の各々に共通に繋がる液体供給孔が形成され、該液体供給孔の開口縁部における液流路高さに対して、前記液体供給孔の中心部における液流路高さが低い、請求項7又は8に記載の液体吐出ヘッド。

【請求項10】 液体吐出エネルギー発生素子上の気泡発生室の断面形状が 凸形状を有する、請求項7又は8に記載の液体吐出ヘッド。

【請求項11】 請求項7~10のいずれかに記載の液体吐出ヘッドを組み込んだインクジェットヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、インクジェット記録方式に用いる記録液小滴を発生するための液体 吐出ヘッドの製造方法及び該方法によって得られた液体吐出ヘッドに関する。特 に本発明は、高画質を可能とする微小な液滴を安定して吐出し、更に高速記録を 実現できるインク流路形状と該ヘッドを生産する製造方法に関する。

[0002]

更に本発明は、前記インクジェットヘッドの製造方法に基づき、インク吐出特性が改善されたインクジェットヘッドに関する。

[0003]

【従来の技術】

インク等の記録液を吐出して記録を行うインクジェット記録方式(液体吐出記録方式)に適用される液体吐出ヘッドは、一般に液流路、該液流路の一部に設けられる液体吐出エネルギー発生部、及び前記液流路の液体を液体吐出エネルギー発生部の熱エネルギーによって吐出するための微細な記録液吐出孔(以下、「オリフィス」と呼ぶ)とを備えている。従来、このような液体吐出記録ヘッドを作製する方法としては、例えば、

・液体吐出用の熱エネルギーを発生するヒーター及びこれらヒーターを駆動するドライバー回路等の形成した素子基板にインク供給の為の貫通孔を形成した後、

感光性ネガレジストにてインク流路の壁となるパターン形成を行い、これに、電 鋳法やエキシマレーザー加工によりインク吐出孔を形成したプレートを接着して 製造する方法(例えばUSP6179413等)

・上記製法と同様に形成した素子基板を用意し、接着層を塗布した樹脂フィルム (通常はポリイミドが好適に使用される)にエキシマレーザーにてインク流路及 びインク吐出孔を加工し、次いで、この加工した液流路構造体プレートと前記素 子基板とを熱圧を付与して貼り合わせる方法(例えばUSP6158843等) 等を挙げることができる。

$[0\ 0\ 0\ 4]$

上記の製法によるインクジェットヘッドでは、高画質記録のために微小液滴の吐出を可能にするため、吐出量に影響を及ぼすヒーターと吐出孔間の距離を出来るだけ短くしなければならない。そのために、インク流路高さを低くしたり、インク流路の一部であって液体吐出エネルギー発生部と接する気泡発生室としての吐出チャンバや、吐出孔のサイズを小さくしたりする必要もある。すなわち、上記製法のヘッドで微小液滴を吐出可能にするには、基板上に積層する液流路構造体の薄膜化が必要とされる。しかし、薄膜の液流路構造体プレートを高精度で加工して基板に貼り合わせることは極めて困難である。

[0005]

これら製法の問題を解決する為、特公平6-45242号公報では、液体吐出エネルギー発生素子を形成した基板上に感光性材料にてインク流路の型をパターンニングし、次いで型パターンを被覆するように前記基板上に被覆樹脂層を塗布形成し、該被覆樹脂層に前記インク流路の型に連通するインク吐出孔を形成した後、型に使用した感光性材料を除去してなるインクジェットヘッドの製法(以下、「注型法」とも略記する。)を開示している。該ヘッドの製造方法では感光性材料としては、除去の容易性の観点からポジ型レジストが用いられている。また、この製法によると、半導体のフォトリソグラフィーの手法を適用しているので、インク流路、吐出孔等の形成に関して極めて高精度で微細な加工が可能である。しかし、該半導体の製造方法を適用した製法においては基本的には、インク流路及び吐出孔近傍の形状変更は素子基板と平行な2次元方向での変更に限定され

5/

てしまう。すなわち、インク流路及び吐出孔の型に感光性材料を用いていること により、感光材層を部分的に多層化することができないので、インク流路等の型 において高さ方向に変化をつけた所望のパターンが得られない(素子基板からの 高さ方向の形状が一様に限定されてしまう)。その結果、高速で安定した吐出を 実現する為のインク流路設計の足かせとなってしまう。

[0006]

一方、特開平10-291317号公報では、液流路構造体のエキシマレーザ ー加工に際して、レーザーマスクの不透明度を部分的に変化せしめて樹脂フィル ムの加工深さを制御せしめて3次元方向、すなわち素子基板と平行な面内方向と 該素子基板からの高さ方向でのインク流路の形状変更を実現することを開示して いる。このようなレーザー加工での深さ方向の制御は原理的には可能であるが、 これら加工に用いられるエキシマレーザーは、半導体の露光に使用されるエキシ マレーザーと異なり、広帯域にて高い輝度のレーザーが使用され、レーザー照射 面内での照度のバラツキを抑えてレーザー照度の安定化を実現することは非常に 難しい。特に高画質のインクジェットヘッドにおいては、各吐出ノズル相互での 加工形状のバラツキによる吐出特性の不均一は印刷画像のムラとなって認識され 、加工精度の向上を実現することが大きな課題となる。

[0007]

さらに、レーザー加工面に付くテーパーにより微細なパターン形成ができない 場合が多い。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、特開平4-216952号公報では、基板上にネガ型レジストの第 一層を形成した後所望のパターンを潜像し、さらに第一層上にネガ型レジストの 第二層を被覆した後に該第二層のみに所望のパターンを潜像し、最後に上下各層 のパターン潜像を現像する方法において、使用する上下2層のネガ型レジストは それぞれ感応波長域を変えたもので、上下の両方のレジストが紫外線(UV)に 感応するもの、あるいは、ネガ型上層レジストは紫外線(UV)に感応するもの で、ネガ型下層レジストはdeep-UV、電子線、またはX線等の電離放射線 に感応するものを用いる方法が開示されている。この製法によると、感応波長領域の異なる上下2層のネガ型レジストを用いることで、基板と平行な方向に関してのみならず基板からの高さ方向に関しても形状を変えたパターン潜像を形成することができる。

[0009]

そこで、本発明者らは、特開平4-216952号公報に開示の技術を、上記の注型法に適用することについて鋭意検討した。つまり、注型法におけるインク流路の型の形成に特開平4-216952号公報の技術を適用すれば、インク流路等の型であるポジ型レジストの高さを局所的に変えることができるであろうと考えた。

[0010]

実際に、特開平4-216952号公報に記載されているような溶解除去可能で紫外線(UV)に感応するものとして、アルカリ可溶性樹脂(ノボラック樹脂やポリビニールフェノール)とナフトキノンジアジド誘導体との混合系からなるアルカリ現像ポジ型フォトレジストを用い、電離放射線に感応するものとしてはポリメチルイソプロペニルケトン(PMIPK)を用い、基板に対して上と下のパターンが異なる型を形成しようと試みた。ところが、該アルカリ現像ポジ型フォトレジストは、PMIPKの現像液に瞬時に溶解してしまい2層のパターン形成はできなかった。

[0011]

そのため、注型法において基板に対して高さ方向の形状を変えた型パターンを 形成できる上層と下層のポジ型感光材料の好ましい組み合わせを見出すことを試 みた。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

本発明は上記の諸点に鑑み成されたものであって、安価、精密であり、また信頼性も高い液体吐出ヘッド及び該ヘッドの製造方法を提供することを目的とする

[0013]

0

特に本発明は、インク流路の3次元的な形状を最適化し、高速にてメニスカス

の振動を抑えてインクを再充填可能なインク流路形状とそのヘッドを製造する製造方法に関する。

[0014]

また、液流路が精度良く正確に、且つ歩留り良く微細加工された構成を有する液体吐出ヘッドを製造することが可能な新規な液体吐出ヘッドの製造方法を提供することも目的とする。

[0015]

また、記録液との相互影響が少なく、機械的強度や耐薬品性に優れた液体吐出 ヘッドを製造し得る新規な液体吐出ヘッドの製造方法を提供することも目的とす る。

[0016]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成する本発明は、先ず、高精度にて3次元形状の液流路を形成する製造を実現し、次いで該製法により実現できる良好な液流路形状を見出したことを特徴としている。

[0017]

すなわち、第1の発明は、基板上に、熱架橋したポジ型感光性材料層(第1のポジ型感光材料層)を形成し、その上に、感光波長域が第1のポジ型感光材料層と異なる第2のポジ型感光性材料層を形成し、まず、第2のポジ型感光性材料層の所望の領域のみを分解反応させた後現像し、該第2のポジ型感光性材料層にパターンを形成した後、第1のポジ型感光性材料層の所定の領域を分解反応させた後現像し、前記第1のポジ型感光性材料層にパターンを形成する、ポジ型感光材料層の上と下のパターンを異ならせる微細構造体の製造において、

第1のポジ型感光材料がメタクリル酸エステルを主成分し、熱架橋因子としてメタクリル酸を含むメタクリル系共重合体組成物とする電離放射線分解型ポジレジストであり、メタクリル酸単位が2~30重量%かつ共重合体の分子量が500~5000であり、

第2のポジ型感光性材料層が、ポリメチルイソプロペニルケトンを主成分とする電離放射線分解型ポジレジストである

ことを特徴とする微細構造体の製造方法を提案する。

[0018]

第2の発明は、液体吐出エネルギー発生素子を形成した基板上の液流路形成部分に除去可能な樹脂にて型パターンを形成し、該型パターンを被覆するように前記基板上に被覆樹脂層を塗布し硬化させた後、前記型パターンを溶解除去して液流路を形成する、液体吐出ヘッドの製造方法において、

前記型パターンを形成する工程が、基板上に、熱架橋反応を用いて熱架橋したポジ型感光性材料層(第1のポジ型感光材料層)を形成する工程、該第1のポジ型感光性材料層の上に、感光波長域が第1のポジ型感光材料層と異なる第2のポジ型感光性材料層を形成する工程、2層のポジ型感光性材料層が形成された基板面に第2のポジ型感光性材料に感光する電離放射線により前記第2のポジ型感光性材料層の所望の領域のみを分解反応させた後、現像し、該第2のポジ型感光性材料層に所望のパターンを形成する工程、および、第2のポジ型感光性材料層上に所望のパターンが形成された基板面に、第1ポジ型感光材料層が感光する電離放射線で第1のポジ型感光性材料層の所定の領域を分解反応させた後、現像し、前記第1のポジ型感光性材料層に所望のパターンを形成する工程を順次含み、

第1のポジ型感光材料がメタクリル酸エステルを主成分し、熱架橋因子としてメタクリル酸を含むメタクリル系共重合体組成物とする電離放射線分解型ポジレジストであり、メタクリル酸単位が2~30重量%かつ共重合体の分子量が500~5000であり、

第2のポジ型感光性材料層が、ポリメチルイソプロペニルケトンを主成分とする電離放射線分解型ポジレジストである

ことを特徴とする液体吐出ヘッドの製造方法 を提供する。

[0019]

第3の発明は、液体吐出エネルギー発生素子を形成した基板上の液流路形成部分に除去可能な樹脂にて型パターンを形成し、該型パターンを被覆するように前記基板上に被覆樹脂層を塗布し硬化させた後、前記型パターンを溶解除去して液

流路を形成する、液体吐出ヘッドの製造において、

前記型パターンを溶解除去する工程では、ネガ型感光性被覆樹脂膜を塗布し、 前記液流路に連通する吐出孔を含むパターンを露光した後、現像して吐出孔部分 を形成し、ついでポジレジスト膜の両方が分解反応する波長域の電離放射線を照 射して、電離放射線分解型ポジレジスト膜からなるレジストパターンを分解し、 基板を有機溶剤に浸漬し、該ポジレジストのレジストパターンを溶解、除去する

ことを特徴とする液体吐出ヘッドの製造方法 を提供する。

[0020]

上記の第1又は第2の発明において、下層のポジ型感光性材料がメタクリル酸 エステルを主成分とする電離放射線分解型ポジレジストであり、熱架橋因子とし て、メタクリル酸を含む2元素系共重合体材料であって、上層のポジ型感光性樹 脂材料がポリメチルイソプロペニルケトンを主成分とする電離放射線分解型ポジ レジストであることが好ましい。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

また、本発明は上記のような液体吐出ヘッドの製造方法で製造した液体吐出へ ッドも包含する。

$[0\ 0\ 2\ 2]$

また、上記のような本発明の製法による液体吐出ヘッドは、液流路にごみ捕捉 用の柱状部材が該液流路を構成する材料より形成されていてるものが好ましく、 さらに該柱状部材は前記基板に到達していないものが好ましい。

[0023]

また、上記のような本発明の製法による液体吐出ヘッドは、前記基板に前記液 流路の各々に共通に繋がる液体供給孔が形成され、該液体供給孔の開口縁部にお ける液流路高さに対して、前記液体供給孔の中心部における液流路高さが低いも のが好ましい。

[0024]

また、上記のような本発明の製法による液体吐出ヘッドは、液体吐出エネルギ

ページ: 10/

ー発生素子上の気泡発生室の断面形状が凸形状を有するものが好ましい。

[0025]

次に、本発明について詳しく説明する。

[0026]

本発明による液体吐出ヘッドの製造においては、液体吐出ヘッドの特性に影響を及ぼす最も重要な因子の一つである、吐出エネルギー発生素子(例えばヒーター)とオリフィス(吐出孔)間の距離および該素子とオリフィス中心との位置精度の設定が極めて容易に実現できる等の利点を有する。即ち、本発明によれば2回にわたる感光性材料層の塗布膜厚を制御することにより吐出エネルギー発生素子とオリフィス間に距離を設定することが可能であり、該感光性材料層の塗布膜厚は従来使用される薄膜コーティング技術により再現性良く厳密に制御できる。また、吐出エネルギー発生素子とオリフィスの位置合せはフォトリソグラフィー技術による光学的な位置合せが可能であり、従来液体吐出記録ヘッドの製造に使用されていた液流路構造体プレートを基板に接着する方法に比べて飛躍的に高い精度の位置合せができる。

[0027]

また、溶解可能なレジスト層としてポリメチルイソプロペニルケトン (PMIPK) やポリビニルケトン等が知られている。これらポジ型レジストは波長290nm附近に吸収のピークを有するレジストであり、該レジストとは異なる感光波長域のレジストと組合せることにより、2層構成のインク流路型を形成できる

[0028]

0

ところで、本発明の製造方法においては、溶解可能な樹脂にてインク流路の型を形成し、流路部材となる樹脂で被覆した後、最後にその型材を溶解除去することを特徴としている。従って、この製法に適用できる型材料は最後に溶解、除去できなければならない。パターン形成後に該パターンを溶解できるレジストは、半導体フォトリソグラフィープロセスで汎用的に適用される、アルカリ可溶性樹脂(ノボラック樹脂やポリビニールフェノール)とナフトキノンジアジド誘導体との混合系からなるアルカリ現像ポジ型フォトレジスト、あるいは電離放射線分

解型レジストの2種がある。アルカリ現像ポジ型フォトレジストの一般的な感光 波長域は400~450nmにあり、上記ポリメチルイソプロペニルケトン(P MIPK)とは感光波長域が異なるが、該アルカリ現像ポジ型フォトレジストは 実際、PMIPKの現像液に瞬時に溶解してしまい2層のパターン形成には適用 できない。

[0029]

一方、電離放射線分解型レジストの一つであるポリメチルメタクリレート(P MMA)等のメタクリル酸エステルから構成される高分子化合物は、感応波長220nm以下の領域にピークを有するポジ型レジストであり、且つ、熱架橋因子として、メタクリル酸を含むメタクリル系共重合体組成物にすることで、熱架橋された膜自体の未露光部分はPMIPKの現像液では、殆ど溶解されることがなく、2層のパターン構成に適用できる。従って、該レジスト(P (MMA-MAA))上に前記したPMIPKから構成されるレジスト層(PMIPK)を形成し、先ず、第2のレジストの波長帯である、290nm付近の波長帯(260~330nm)にて上層のPMIPKを露光、現像し、次いで第1の波長帯である波長帯(210~330nm)の電離放射線で下層のPMMAを露光、現像することにより、2層のインク流路型パターンを形成できる。

[0030]

本発明に最も好適な熱架橋型レジストとは、架橋基としてメタクリル酸を共重合したメタクリル酸エステルを挙げることができる。メタクリル酸エステルとしては、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸フェニル等を挙げることができる。

[0031]

架橋成分の共重合比は下層レジストの膜厚により最適化することが好ましいが、熱架橋因子であるメタクリル酸の共重合量としては、2~30重量%が望ましい。更に、好ましくは、2~10重量%が望ましい。又、メタクリル酸エステルとメタクリル酸のメタクリル系共重合体の分子量としては、5000~50000が望ましい。分子量が大きくなると、ソルベントコート用途での溶剤への溶解度が下がり、且つ、溶解できたとしても、溶液自体の粘度が高くなりすぎて、ス

ピンコート法による塗布工程において、膜厚の均一性が低下してしまう。

[0032]

更に、分子量が大きいと、第1の波長帯である210~330nm領域の電離 放射線に対する分解効率が悪くなり、所望の膜厚で、所望のパターンを形成する ための露光量が、非常に多く必要になり、且つ、現像液に対する対現像性も悪化して、形成するパターン精度を劣化させることになる。分子量が小さくなりすぎ ると、溶剤への溶解度が異常に高くなり、溶液の粘度が著しく低下して、所望の 膜厚をスピンコート法で形成できなくなってしまう。そこで、メタクリル酸エステルとメタクリル酸の2元素系共重合体の分子量としては、5000~3000 0が望ましい。

[0033]

なお、メタクリル系共重合体は、メタクリル酸エステルおよびメタクリル酸を 重合溶媒、例えば、トルエン、キシレンに溶解し、アゾ系重合触媒あるいは過酸 化物重合触媒の存在下に、通常重合溶媒の沸点以下室温以上に加熱することによ って製造される。なお、本発明で用いるメタクリル系共重合体は加熱により架橋 する性質があるため、重合は60~80℃で行うことが好ましい。

[0034]

以下、本発明の製造方法によるインク流路形成のプロセスフローを説明する。

[0035]

図1及び図2に、下層レジストとして熱架橋ポジ型レジストを適用した最も好 適なプロセスフローを示す。図1は図2の工程の続きを示す。

[0036]

図1 (a) にて基板 3 1 上に熱架橋ポジ型レジスト層 3 2 を塗布し、ベークする。塗布はスピンコートやバーコート等の汎用的なソルベントコート法を適用できる。またベーク温度は熱架橋反応が行われる 1 6 0 ~ 2 2 0 $\mathbb C$ で、 3 0 分から 2 時間が好ましい。

[0037]

次いで、図1(b)に示すように、熱架橋型ポジレジストの上層にPMIPK を主成分とするポジ型レジスト層33を塗布し、ベークする。一般的には、上層 のPMIPK塗布時の塗布溶剤により、下層も若干溶解し相溶層が形成されるが、本構成では熱架橋型としている為、全く相溶層は形成されない。

[0038]

次いで、図1 (c) に示すようにポジ型レジスト層33であるPMIPK層を露光し、290 nm付近の波長を良好に反射するコールドミラーを用いることが好ましい。例えばウシオ電機(株) 製のマスクアライナーUX-3000SCを適用して、図3に示すように、蝿の目レンズを含むインテグレータの先に、260 nm以下の光を遮断するカットフィルタを用いることで、図4に示すように、第2の波長帯である260~330nmの光のみを基板上に透過することが可能である。

[0039]

次いで、図1(d)に示すように上層レジスト層33の現像を行う。現像はPMIPKの現像液であるメチルイソブチルケトンを用いることが好ましいが、PMIPKの露光部を溶解し、未露光部を溶解しない溶剤であれば何れも適用可能である。

[0040]

さらに、図1 (e)に示すように下層の熱架橋型ポジ型レジスト層32を露光する。この露光は、前記カットフィルタを使用せずに、図5に示すような第1の波長帯である210~330nmの光を用いて、行う。この時に上層のPMIP Kはフォトマスク37により光照射されないため、感光しない。

[0041]

次いで、図1 (f)で示すように熱架橋形ポジ型レジスト層32を現像する。 現像はメチルイソブチルケトンで行うことが好ましい。上層PMIPKの現像液 と同一であり、上層パターンへの現像液の影響を無くすことが可能となる。

$[0\ 0\ 4\ 2]$

次いで、図1(g)に示すように、下層の熱架橋型ポジ型レジスト層32及び上層のポジ型レジスト層33を覆うように液流路構造体材料34を塗布する。塗布は汎用的なスピンコート等のソルベントコート法を適用できる。

[0043]

ここで用いる液流路構造体材料として、常温にて固体状のエポキシ樹脂と光照射によりカチオンを発生するオニウム塩を主成分とする材料が好ましく、ネガ型の特性を有している。なお、詳しくは、特許第3143307号に記載されている。

[0044]

すなわち、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化物は、通常の酸無水物もしくはアミンによる硬化物に比較して高い架橋密度(高Tg)を有するため、構造材として優れた特性を示す。また、常温にて固体状のエポキシ樹脂を用いることで、光照射によりカチオン重合開始剤より発生した重合開始種のエポキシ樹脂中への拡散が抑えられ、優れたパターニング精度、形状を得ることができる。

[0045]

本発明に用いる固体状のエポキシ樹脂としては、ビスフェノールAとエピクロヒドリンとの反応物のうち分子量がおよそ900以上のもの、含ブロモスフェノールAとエピクロヒドリンとの反応物、フェノールノボラックあるいはoークレゾールノボラックとエピクロヒドリンとの反応物、特開昭60-161973号公報、特開昭63-221121号公報、特開昭64-9216号公報、特開平2-140219号公報に記載のオキシシクロヘキサン骨格を有する多感応エポキシ樹脂等があげられるが、もちろん本発明はこれら化合物に限定されるわけではない。

[0046]

また、ここで用いるエポキシ樹脂において、好ましくはエポキシ当量が200 0以下、さらに好ましくは1000以下であることが好ましい。これは、エポキシ当量が2000を越えると、硬化反応の際に架橋密度が低下し、硬化物のTg もしくは熱変形温度が低下したり、密着性、耐インク性に問題が生じる場合があるからである。

[0047]

エポキシ樹脂を硬化させるための光カチオン重合開始剤としては、芳香族ヨードニウム塩、芳香族スルホニウム塩 [J. POLYMER SCI: Symposium No. 56 383-395 (1976)参照] や旭電化工業株式会社よ

り上市されているSP-150、SP-170等が挙げられる。

[0048]

上記組成物に対して必要に応じて添加剤など適宜添加することが可能である。 例えば、エポキシ樹脂の弾性率を下げる目的で可撓性付与剤を添加したり、ある いは基板との更なる密着力を得るためにシランカップリング剤を添加することな どがあげられる。

[0049]

図2(a)では液流路構造体材料に光照射を行う工程を示すが、インク吐出孔となる箇所に光を照射させないフォトマスク38を適用している。

[0050]

次に、図2(b)に示すように、感光性の液流路構造体材料34に対してインク吐出孔35のパターン現像を行う。このパターン露光は汎用的な露光装置の何れの物を適用しても構わない。この感光性の液流路構造体材料の現像はPMIP Kを溶解しない、キシレン等の芳香族溶剤にて行うことが好ましい。

[0051]

また、液流路構造体材料層上に撥水性被膜を形成したい場合は、特開2000 -326515号公報に記載されるように、感光性撥水材層を形成し、一括にて 露光、現像することにより実施することが可能である。この時、感光性撥水層の 形成はラミネートにより実施することが可能である。

[0052]

次いで、図2(c)に示すように、液流路構造体材料層越しに300nm以下の電離放射線を一括で照射する。これは、PMIPKや架橋型レジストを分解して低分子化し、除去を容易に行えることを目的としている。

[0053]

最後に、型に用いたポジ型レジスト32,33を溶剤にて除去する。これにより、図2(d)に示すように吐出チャンバを含む液流路39が形成される。

[0054]

以上記載した工程を適用することにより、インク供給孔からヒーターまでのインク流路の高さを変化せしめることが可能である。

[0055]

このような製法により、インク供給孔からヒーターまでのインク流路の高さを変化させることが可能となる。インク供給孔から吐出チャンバまでのインク流路形状を最適化することは、吐出チャンバにインクを再充填する速度と大きな関係を有するばかりでなく、吐出チャンバ間のクロストークを低減させることが可能である。Truebaらの米国特許4882595号明細書では、基板上に感光性レジストより形成されるインク流路の2次元的、すなわち該基板と平行な方向の形状と上記特性との関係を開示している。一方、マーシーらの特開平10-291317号公報では樹脂性の液流路構造体プレートをエキシマレーザーにて基板に対する面内方向と高さ方向の3次元方向に加工し、インク流路の高さを変化させることを開示している。

[0056]

しかしながら、エキシマレーザーによる加工は、加工時の熱によるフィルムの膨張等により十分な精度を実現できない場合が多い。特に、エキシマレーザーによる樹脂フィルムの深さ方向の加工精度はレーザーの照度分布やレーザー光の安定性に影響を受け、インク流路形状と吐出特性の相関を明確にできる精度を確保できない。従って、特開平10-291317号公報では、インク流路の高さ形状と吐出特性との明確な相関は記載されていない。

[0057]

本発明に関わる製法は、半導体製造技術で用いられるスピンコート等のソルベントコート法により実施される為、インク流路はその高さが極めて高精度で安定的に形成できる。また、基板に対して平行な方向の2次元的な形状も半導体のフォトリソグラフィー技術を用いる為、サブミクロンの精度を実現することが可能である。

[0058]

これら製法を適用して本件発明者らがインク流路高さと吐出特性の相関を検討し、以下の発明に至った。図6から図9を用いて本発明の製法を適用した液体吐出ヘッドの好ましい態様を説明する。

[0059]

本発明の第1の態様のヘッドは図6 (a) に示すように、インク供給孔44の端部42aから吐出チャンバ47に至るまでのインク流路の高さを、吐出チャンバ47に隣接する箇所にて低くすることを特徴としている。

[0060]

図6 (b) は上記第1の態様と比較するインク流路形状を示す。吐出チャンバ47にインクを再充填する速度は、インク供給孔42から吐出チャンバ47までのインク流路の高さが高い程、インクの流抵抗を低くすることができるので高速になる。しかし、該インク流路の高さを高くした場合、吐出圧力がインク供給孔42側にも放出され、エネルギー効率が低下したり、また吐出チャンバ47間のクロストークも甚だしくなる。

[0061]

従って、インク流路の高さは上記2種の特性を鑑みながら設計される。そこで本製法を適用することにより、インク流路高さを変化させることが可能となり、図6(a)のインク流路形状を実現できる。

[0062]

該ヘッドはインク供給孔42から吐出チャンバ47近傍までインク流路の高さを高くすることにより、インクの流抵抗を低下させて高速での再充填を可能とする。さらに、吐出チャンバ47近傍ではインク流路の高さを低くすることにより、吐出チャンバ47で発生するエネルギーのインク供給孔42側への放出を抑え、クロストークを防止する構成となっている。

[0063]

次に、本発明の第2の態様のヘッドは図7に示すように、インク流路中に柱状のゴミ補捉部材(以下、「ノズルフィルター」と記す。)を形成したことを特徴とする。

$[0\ 0\ 6\ 4]$

特に図7(a)では、ノズルフィルター58を基板51に到達しない形状としている。また図7(b)では基板51に到達したノズルフィルター59を示す。このようなノズルフィルター58,59はインクの流抵抗を高め、インクの吐出チャンバ57への再充填速度を遅くする原因となる。しかし、高画質記録を実現

するインクジェットヘッドのインク吐出孔は極めて小さく、前記ノズルフィルターを設けない場合、ゴミ等がインク流路や吐出孔に詰り、インクジェットヘッドの信頼性を大幅に低下させてしまう。

[0065]

本発明では、隣り合うノイズフィルター間の間隔を従来と同一にしたまま、インク流路面積を最大にできる為、インクの流抵抗の増大を抑えてゴミを補捉できる。つまり、柱状のノイズフィルターを液流路に設けても、インクの流抵抗が高まることが無いようにインク流路高さを変えることができる。

[0066]

例えば、直径 10μ mを越えるゴミを補捉する場合、隣り合うフィルター間の距離は 10μ m以下にすれば良いが、この時のノイズフィルターを構成する柱を、より好ましくは図7(a)に示すように基板51まで到達しない構成にすることにより、流路断面積を大きくすることができる。

[0067]

次に、本発明の第3の態様のヘッドは図8(a)に示すように、インク供給孔62の中心部に対応する液流路構造体材料65のインク流路高さをインク供給孔62の開口縁部62bに対応するインク流路部より低くしている。図8(b)は前記第3の態様と比較するインク流路形状を示す。図6(a)を参照して前述したヘッド構成において、インク供給孔42の端部42aから吐出チャンバ47までのインク流路の高さを高くした場合、図8(b)に示すようにインク供給孔62に対応する液流路構造体材料65の膜厚も薄くなり、インクジェットヘッドの信頼性が極めて低下する可能性がある。例えば記録中に紙ジャムが起こった場合など、液流路構造体材料65を形成する膜が破れてインク漏れに至る場合が想定される。

[0068]

しかし、本製法では図8(a)に示すように、インク供給孔62のほぼ開口全体に対応する液流路構成材料65を厚くし、インクの供給に必要なインク供給孔62の開口縁部62b付近に対応する部分のみの流路高さを高くすることにより、前述した弊害を回避できる。液流路構成材料65にて流路高さを高く構成する

箇所の、インク供給孔開口縁62bからの距離は、設計するインクジェットへッドの吐出量やインク粘度により決定されるが、一般的には $10~100~\mu~m$ 程度が好適である。

[0069]

次に、本発明の第4の態様のヘッドは図9(a)に示すように、吐出チャンバ77の吐出孔形状が凸の断面形状であることを特徴としている。図9(b)は前記第4の態様と比較する吐出チャンバの吐出孔形状を示す。インクの吐出エネルギーはヒーター上部の吐出孔形状に規定されるインクの流抵抗により大きく変化するが、従来製法では、吐出孔形状は液流路構造体材料のパターニングにより形成するため、マスクに形成された吐出孔パターンが投影された形状となる。従って原理的には液流路構造体材料表面の吐出孔開口面積と同一の面積で吐出孔が液流路構造体材料の層を貫通して形成される。

[0070]

しかしながら、本発明の製法では、下層材料と上層材料のパターン形状を変えることにより、吐出チャンバ77の吐出孔形状を凸形状に形成することができる。このことは、インク吐出速度を速めたり、またインクの直進性を増す効果があり、より高画質の記録を行える記録ヘッドを提供できる。

[0071]

【発明の実施の形態】

以下、必要に応じて図面を参照しつつ、本発明を詳細に説明する。

(第1の実施の形態)

図10~19の夫々には、本発明の方法に係わる液体噴射記録ヘッドの構成とその製作手順の一例が示されている。ここにおいては第1のポジ型感光性材料層と第2のポジ型感光性材料層の上下関係についてこれらの要部を用いて模式的に示すもので、その他の具体的構造については適宜省略してある。

[0072]

本例では、2つのオリフィス(吐出孔)を有する液体噴射記録ヘッドが示されるが、もちろんこれ以上のオリフィスを有する高密度マルチアレイ液体噴射記録 ヘッドの場合でも同様であることは、言うまでもない。

[0073]

まず、本実施形態においては、例えば図10に示されるような、ガラス、セラミックス、プラスチックあるいは金属等からなる基板201が用いられる。なお、図10は感光性材料層形成前の基板の模式的斜視図である。

[0074]

このような基板201は、液流路の壁部材の一部として機能し、また後述の感光性材料層からなる液流路構造体の支持体として機能し得るものであれば、その形状、材質等、特に限定されることなく使用できる。上記の基板201上には、電気熱変換素子あるいは圧電素子等の液体吐出エネルギー発生素子202が所望の個数配置される(図10では2個にて例示)。このような、液体吐出エネルギー発生素子202によって記録液小滴を吐出させるための吐出エネルギーがインク液に与えられ、記録が行なわれる。

[0075]

因みに、例えば、液体吐出エネルギー発生素子202として電気熱変換素子が 用いられるときには、この素子が近傍の記録液を加熱することにより、吐出エネ ルギーを発生する。また、例えば、圧電素子が用いられるときは、この素子の機 械的振動によって、吐出エネルギーが発生される。

[0076]

なお、これらの素子202には、これら素子を動作させるための制御信号入力 用電極(図示せず)が接続されている。また、一般にはこれら吐出エネルギー発 生素子202の耐用性の向上を目的として、保護層等の各種機能層が設けられる が、もちろん本発明においてもこの様な機能層を設けることは一向に差しつかえ ない。

[0077]

最も汎用的には、基板201としてはシリコンが適用される。即ち、吐出エネルギー発生素子を制御するドライバーやロジック回路等は、汎用的な半導体製法にて生産される為、該基板にシリコンを適用することが好適である。また、該シリコン基板にインク供給の為の貫通孔を形成する方法としては、YAGレーザーやサンドブラスト等の技術を適用することも可能ではある。

[0078]

しかし、下層材料として熱架橋型レジストを適用する場合は、該レジストのプリベーク温度は前述したように極めて高温であり、樹脂のガラス転移温度を大幅に越え、プリベーク中に樹脂被膜が貫通孔に垂れ下がる。従って、レジスト塗布時には基板に貫通孔が形成されていないことが好ましい。

[0079]

このような方法は、アルカリ溶液によるシリコンの異方性エッチ技術を適用できる。この場合、基板裏面に耐アルカリ性の窒化シリコン等にてマスクパターンを形成し、基板表面には同様の材質でエッチングストッパーとなるメンブレン膜を形成しておけば良い。

[0080]

次いで図11に示すように、液体吐出エネルギー発生素子202を含む基板201上に、架橋型ポジレジスト層203を形成する。この材料は、メチルメタクリ酸とメタクリル酸の90:10比の共重合体(P(MMA-MAA)と表す)で、重量平均分子量(Mw)33000、平均分子量(Mn)14000および分散度(Mw/Mn)2.36である。

[0081]

ここで、下層を形成する熱架橋型ポジレジストであるP(MMA-MAA)と、上層を形成するポジレジストであるPMIPKとの吸収スペクトルの違いを図22に示す。図22で示すように、上下層を形成する材料の吸収スペクトルの違いにより、露光時の波長帯を選択的に変化させることで、凸型形状の型レジストパターンを形成することができる。

この樹脂粒子をシクロヘキサノンに30WT%の濃度にて溶解し、レジスト液として使用した。該レジスト液はスピンコート法にて上述した基板201に塗布し、オーブンにて200 $\mathbb C$ 、60分間のプリベークを行い、熱架橋せしめた。形成した被膜の膜厚は10 μ mであった。

[0082]

次いで図12に示すように、熱架橋型ポジレジスト層203上にPMIPKのポジレジスト層204を塗布した。PMIPKは、東京応化工業株式会社より上



市されるODUR-1010を樹脂濃度が20WT%となるように調整して使用した。プリベークはホットプレートにて120℃、6分間行った。該被膜の膜厚は10 μ mであった。

[0083]

次いで図13に示すように、PMIPKのポジレジスト層204の露光を行った。露光装置はウシオ電機製DeepUV露光装置:UX-3000SCを使用して、260nm以下の光を遮蔽するカットフィルタを装着して、図4に示すような第2の波長帯である260~330nm帯領域で行った。露光量は10J/cm²である。電離放射線205をPMIPKに、残したいパターンを描いたフォトマスク206を介して露光した。

[0084]

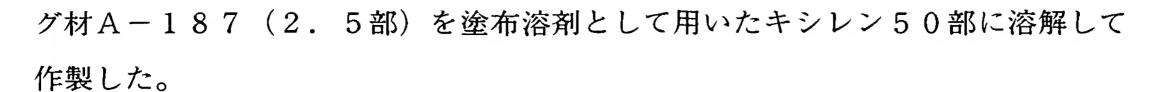
次いで図14に示すように、PMIPKのポジレジスト層204の現像を行ってパターン形成した。現像はメチルイソブチルケトンに1分間浸漬して行った。

[0085]

次いで、図15に示すように、下層の熱架橋型ポジレジスト層203のパターニング(露光、現像)を行った。露光装置は同一の装置を用い、図5に示すような第1の波長帯である210~330nm帯領域で行った。この時の露光量は35J/cm²であり、現像はメチルイソブチルケトンにて行った。露光は、電離放射線を熱架橋型ポジレジストに、残したいパターンを描いたフォトマスク(不図示)を介して露光した。この時、マスクからの回析光により上層のPMIPKパターンが細るため、PMIPK残存部はそのような細りを加味して設計してある。もちろん、回析光の影響のない投影光学系を有する露光装置を用いた場合は、細りを加味したマスク設計を行う必要はない。

[0086]

次いで、図16に示すように、パターニングされた下層の熱架橋型ポジレジスト層203と上層のポジレジスト層204を覆うように液流路構造体材料207の層を形成した。この層の材料は、ダイセル化学工業株式会社より上市されるEHPE-3150(50部)、旭電化工業株式会社より上市される光カチオン重合開始材SP-172(1部)、日本ユニカ社より上市されるシランカップリン



[0087]

塗布はスピンコートにて行い、プリベークはホットプレートにて90℃、3分間行った。

[0088]

次いで、液流路構造体材料 207に対してインク吐出孔 209を形成するためのパターン露光および現像を行う。このパターン露光は汎用的な露光装置の何れのものを適用しても構わない。図示しないが、露光時にはインク吐出孔となる箇所に光を照射させないマスクを使用した。露光はキヤノン製マスクアライナーMPA-600Superを使用し、露光は 500mJ/cm 2 で行った。現像はキシレンに 60秒間浸漬して行った。その後、100℃にて 1 時間のベークを行い、液流路構造体材料の密着性を高めた。

[0089]

その後、図示しないが、液流路構造体材料層上に、該材料層をアルカリ溶液から保護する為に環化イソプレンを塗布した。この材料は東京応化工業社よりOB Cの名称で上市される材料を用いた。その後、シリコン基板をテトラメチルアンモニウムハイドライド(TMAH)22wt%溶液、83℃に14.5時間浸漬し、インク供給の為の貫通孔(不図示)を形成した。また、インク供給孔形成のためにマスク及びメンブレンとして使用した窒化シリコンはシリコン基板に予めパターニングしてある。このような異方性エッチング後にシリコン基板を裏面が上になるようにドライエッチング装置に装着し、CF4に酸素5%を混合したエッチャントにてメンブレン膜を除去した。次いで、前記シリコン基板をキシレンに浸漬してOBCを除去した。

[0090]

次いで図17に示すように、低圧水銀灯を用いて210~330nm領域帯の電離放射線208を液流路構造体材料207に向けて全面照射し、PMIPKの上層ポジ型レジストと、下層の熱架橋型ポジレジストを分解した。照射量は81J/cm²である。



その後、基板201を乳酸メチルに浸漬して、図18の縦断面図に示すように型レジストを一括除去した。この時、200MHzのメガソニック槽に入れ溶出時間の短縮を図った。これにより、吐出チャンバを含むインク流路211が形成され、インク供給孔210から各インク流路211を介して各吐出チャンバにインクを導いて、ヒーターによって吐出孔209より吐出させる構造のインク吐出エレメントが作製される。

[0092]

このように作製した吐出エレメントは図19に示す形態のインクジェットへッドユニットに実装され、吐出、記録評価を行ったところ良好な画像記録が可能であった。前記インクジェットヘッドユニットの形態としては図19に示すように、例えばインクタンク213を着脱可能に保持した保持部材の外面に、記録装置本体と記録信号の授受を行うためのTABフィルム214が設けられ、TABフィルム214上にインク吐出エレメント212が電気接続用リード215により電気配線と接続されている。

(第2の実施の形態)

第1の実施の形態の製法により、図6 (a) に示した構造のインクジェットへッドを作製した。

[0093]

本実施形態では図20に示すとおり、インクジェットへッドはインク供給孔42の開口縁部42aから吐出チャンバ47のインク供給孔側の端部47aまでの水平距離が 100μ mである。インク流路壁46は、吐出チャンバ47のインク供給孔側の端部47aからインク供給孔42側へ 60μ mの箇所まで形成され、夫々の吐出エレメントを分割している。また、インク流路高さは吐出チャンバ47のインク供給孔側の端部47aからインク供給孔42側へ 10μ mに亘って 10μ m、それ以外の個所は 20μ mで形成されている。基板41の表面から液流路構造体材料45の表面までの距離は 26μ mである。

[0094]

図20(b)には従来製法によるインクジェットヘッドの流路断面を示すが、



該ヘッドはインク流路高さが全域に渡って15μmで構成した。

[0095]

図20の(a),(b)の夫々のヘッドのインク吐出後の再充填速度を計測したところ、図20(a)の流路構造では 45μ sec、図20(b)の流路構造では 25μ secであり、本実施形態の製法によるインクジェットヘッドによると、極めて高速にインクの再充填が行われることが判明した。

(第3の実施の形態)

第1の実施の形態の製法により、図7 (a) に示したノズルフィルターを有するヘッドを試作した。

[0096]

図7(a)を参照するとノズルフィルター58はインク供給孔52の開口縁部から吐出チャンバ57側へ20 μ m離れた位置に直径3 μ mの柱を形成することで構成されている。ノイズフィルターを構成する柱と柱の間隔は10 μ mである。図7(b)に示す、ノズルフィルター59は本実施形態のノイズフィルターと位置および形状は同じであるが、基板51まで達している点で異なる。

[0097]

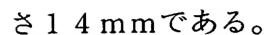
図7の(a),(b)の夫々のヘッドを試作し、インク吐出後のインク再充填速度を計測したところ、図7(a)のフィルター構造では 58μ secであり、図7(b)のフィルター構造では 65μ secであった。図7(a)の形状のインクジェットヘッドによると、インクの再充填時間が短縮できる。

(第4の実施の形態)

第1の実施の形態の製法により、図8(a)に示した構造のインクジェットへッドを試作した。

[0098]

図8 (a) を参照すると、インク供給孔62に対応するインク流路の高さはインク供給孔62の開口縁部62bからその供給孔中心部方向に30 μ mの箇所まで高く構成され、液流路構造体材料65の層厚が6 μ mである。この箇所以外の、インク供給孔62に対応するインク流路の高さは、液流路構造体材料65の層厚が16 μ mにて構成されている。なお、インク供給孔62は幅200 μ m、長



[0099]

図8(b)に示すヘッドにおいては液流路構造体材料65のインク供給孔62に対応する部分の層厚は6μmである。

[0100]

図8の(a),(b)の夫々のヘッドを試作し、高さ90cmよりヘッドの落下試験を行ったところ、図8(b)のヘッド構造では10個中9個のヘッドで液流路構造体材料65にクラックが入ったが、図8(a)のヘッド構造では10個中クラックの入ったヘッドは皆無であった。

(第5の実施の形態)

第1の実施の形態により、図9 (a) に示した構造のインクジェットヘッドを 試作した。

[0101]

本実施形態では図21 (a) に示すとおり、吐出チャンバ77は下層レジストより形成される矩形部が25 μ mの正方形にて高さ10 μ m、上層レジストより形成される矩形部が20 μ mの正方形にて高さ10 μ m、吐出孔は直径15 μ mの丸穴より構成される。ヒーター73から吐出孔74の開口面までの距離は26 μ mである。

[0102]

図 2 1 (b) は従来製法によるヘッドの吐出孔の断面形状を示し、吐出チャンバ77は一辺 2 0 μ mの矩形であり、高さ 2 0 μ mである。吐出孔 7 4 は直径 1 5 μ mの丸穴で形成されている。

[0103]

図21の(a), (b)の夫々のヘッドの吐出特性を比較したところ、図21 (a)に示すヘッドは吐出量3 n gにて吐出速度 $15\,\text{m/s}$ e c、吐出孔 $74\,\text{m}$ ら吐出方向に $1\,\text{m}$ m離れた位置での着弾精度は $3\,\mu$ mであった。また図21 (b)に示すヘッドは吐出量 $3\,\text{n}$ gにて吐出速度 $9\,\text{m/s}$ e c、着弾精度は $5\,\mu$ mであった。

[0104]





本発明によれば、下記に列挙する項目の効果を奏する。

- 1)液体吐出ヘッド製作の為の主要工程が、フォトレジストや感光性ドライフィルム等を用いたフォトリソグラフィー技術による為、液体吐出ヘッドの液流路構造体の細密部を、所望のパターンで、しかも極めて容易に形成することができるばかりか、同構成の多数の液体吐出ヘッドを同時に加工することも容易にできる。
- 2) 液流路の高さを部分的に変えることが可能であり、記録液の再充填速度が速く高速で記録できる液体吐出ヘッドを提供できる。
- 3) 液流路構造体材料層の厚さを部分的に変えることが可能であり、機械的強度 の高い液体吐出ヘッドを提供できる。
- 4) 吐出速度が速く、極めて着弾精度の高い液体吐出ヘッドが製造できる為、高画質の記録を行うことができる。
- 5) 高密度マルチアレイノズルの液体吐出ヘッドが簡単な手段で得られる。
- 6) 液流路の高さ、およびオリフィス部(吐出孔部)の長さの制御は、レジスト膜の塗布膜厚によって簡単且つ精度良く変えられる為、設計の変更と制御が容易に実施できる。
- 7) 熱架橋型ポジレジストを適用することにより、極めてプロセスマージンの高い工程条件を設定でき、歩留まり良く液体吐出ヘッドを製造できる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の製法の基本的工程フローを示す図である。
- 【図2】 図1の工程の続きを示す図である。
- 【図3】 汎用的な露光装置の光学系の模式図と2種のコールドミラーの反射スペクトルを示す図である。
- 【図4】 本発明の製法において、下層に熱架橋型メタクリレート系レジストを用いる場合の工程フローを示す図である。
 - 【図5】 図4の工程の続きを示す図である。
- 【図6】 (a) は本発明の製法による、記録速度が改善されたインクジェットヘッドのノズル構造を示す縦断面図、(b) は従来製法によるインクジェッ

トヘッドのノズル構造を示す縦断面図である。

- 【図7】 (a)は本発明の製法による、改善されたノズルフィルター形状を有するインクジェットヘッドを示す縦断面図、(b)は従来形状のノイズフィルターを有するインクジェットヘッドを示す縦断面図である。
- 【図8】 (a)は本発明の製法による、強度を改善したインクジェットヘッドのノズル構造を示す縦断面図、(b)は(a)に示したヘッドと比較するノズル構造を示す縦断面図である。
- 【図9】 (a) は本発明の製法による、吐出チャンバを改善したインクジェットヘッドのノズル構造を示す縦断面図、(b) は(a) に示したヘッドと比較するノズル構造を示す縦断面図である。
- 【図10】 本発明の一実施形態による製法を説明するための模式的斜視図である。
- 【図11】 図10に示す製造状態の次工程を説明するための模式的斜視図である。
- 【図12】 図11に示す製造状態の次工程を説明するための模式的斜視図である。
- 【図13】 図12に示す製造状態の次工程を説明するための模式的斜視図である。
- 【図14】 図13に示す製造状態の次工程を説明するための模式的斜視図である。
- 【図15】 図14に示す製造状態の次工程を説明するための模式的斜視図である。
- 【図16】 図15に示す製造状態の次工程を説明するための模式的斜視図である。
- 【図17】 図16に示す製造状態の次工程を説明するための模式的斜視図である。
- 【図18】 図17に示す製造状態の次工程を説明するための模式的縦断面図である。
 - 【図19】 図10~18に示した製法で得たインク吐出エレメントが実装

ページ: 29/

されたインクジェットヘッドユニットを示す模式的斜視図である。

- 【図20】 従来製法と本発明の製法のインク再充填性を比較する為に作製したヘッドのノズル構造を示す図である。
- 【図21】 従来製法と本発明の製法の吐出特性を比較する為に作製したヘッドのノズル構造を示す図である。
- 【図22】 本発明で用いるポジ型レジストの吸収スペクトルを示す図である。

【符号の説明】

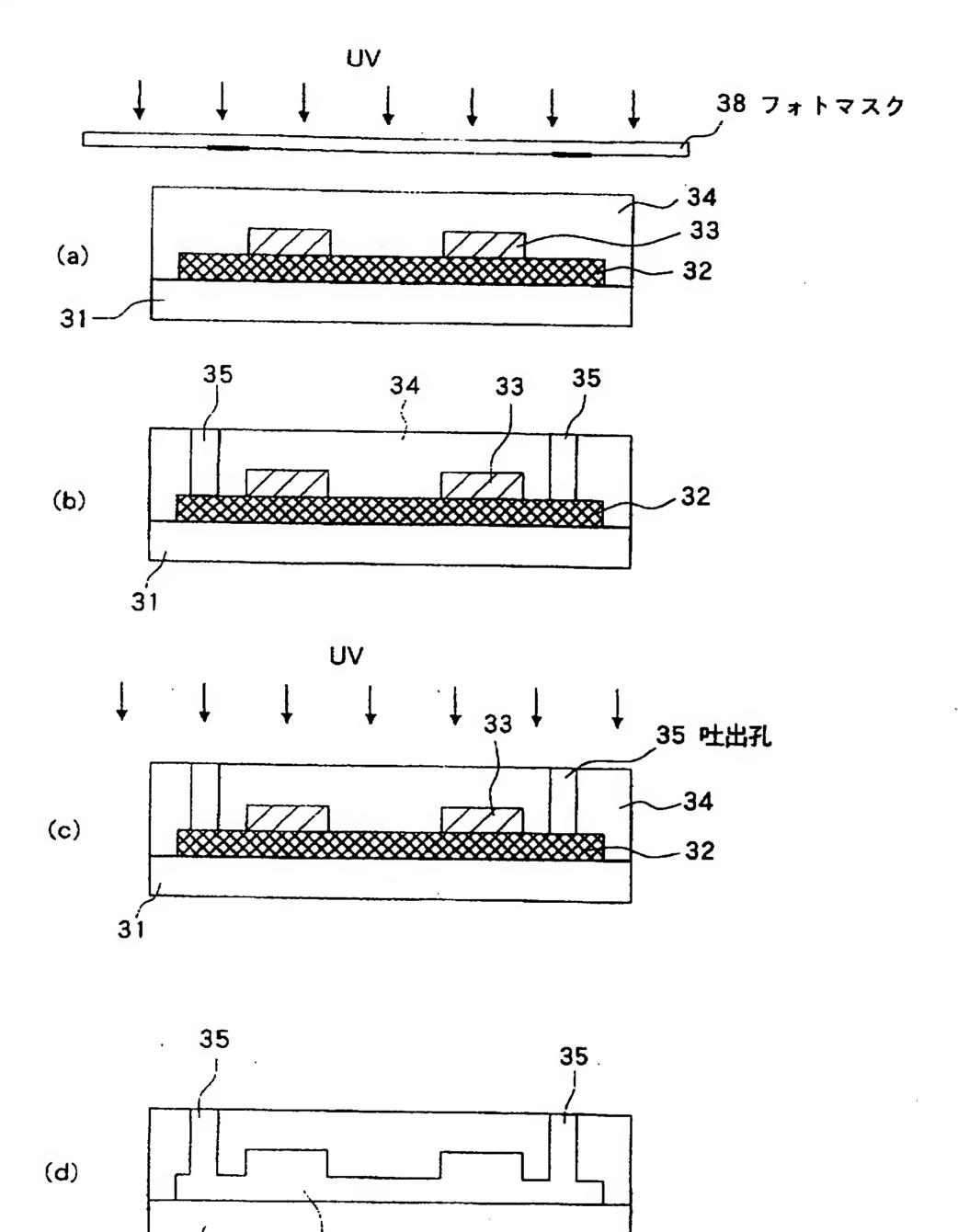
(

- 31、41、51、61、71、201 基板
- 3 2 熱架橋ポジ型レジスト層 (PMMA)
- 33 ポジ型レジスト層 (PMIPK)
- 34、45、55、65、75、207 液流路構造体材料
- 35、209 吐出孔
- 36、37、38、206 フォトマスク
- 3 9 液流路
- 42、52、62、72、210インク 供給孔
- 43、53、63、73 ヒーター
- 44、54、64、74 インク吐出孔
- 46、56、66、76 インク流路壁
- 47、57、67、77 吐出チャンバ
- 58、59 ノイズフィルター
- 100 高圧水銀灯
- 101 コールドミラー
- 102 蝿の目レンズ
- 103 反射集光器
- 104 水銀灯スクリーン
- 105 コンデンサーレンズ
- 106 マスク
- 202 液体吐出エネルギー発生素子

- 203 架橋型ポジレジスト層
- 204 ポジレジスト層
- 205、208 電離放射線
- 2 1 1 インク流路
- 212 インク吐出エレメント
- 213 インクタンク
- 214 TABフィルム
- 2 1 5 電気接続用リード

【書類名】 図面 【図1】 ,32 熱架橋ポジ型レジスト層 (a) 〜31 基板 _33 ポジ型レジスト層(PMIPK) (b) -32 31 ↓ UV 36 フォトマスク 33 (c) 31 33 (d) 31 UV 37 フォトマスク 33 (e) 32 31 33 32 (f) -31 34 液流路構造体材料 33 32-(g) 31-

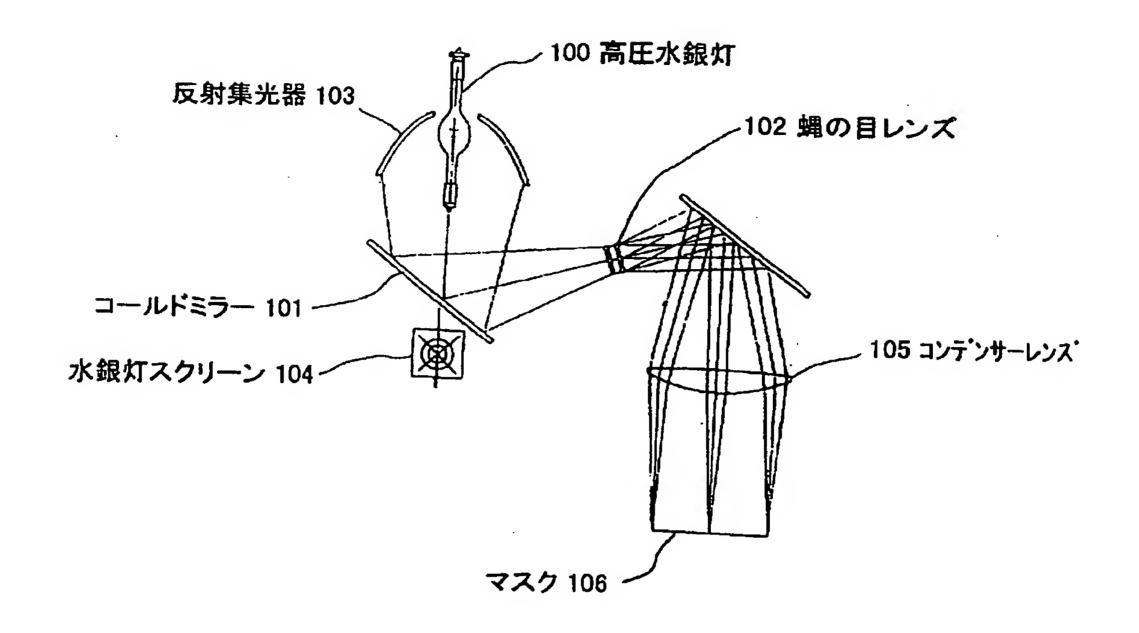
【図2】



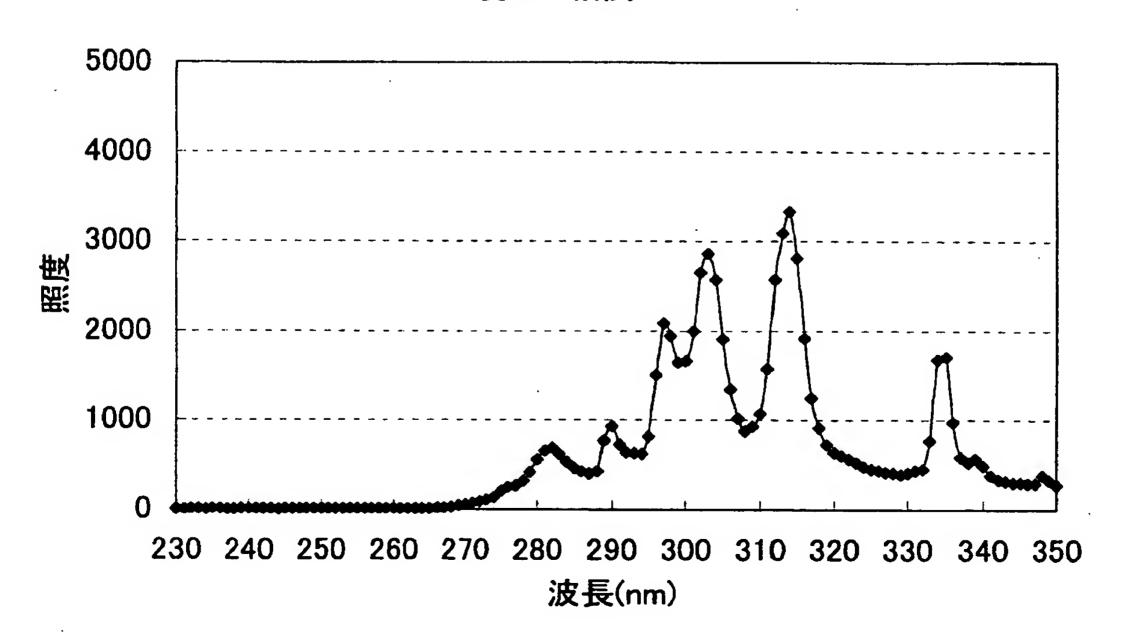
39 液流路

31

【図3】



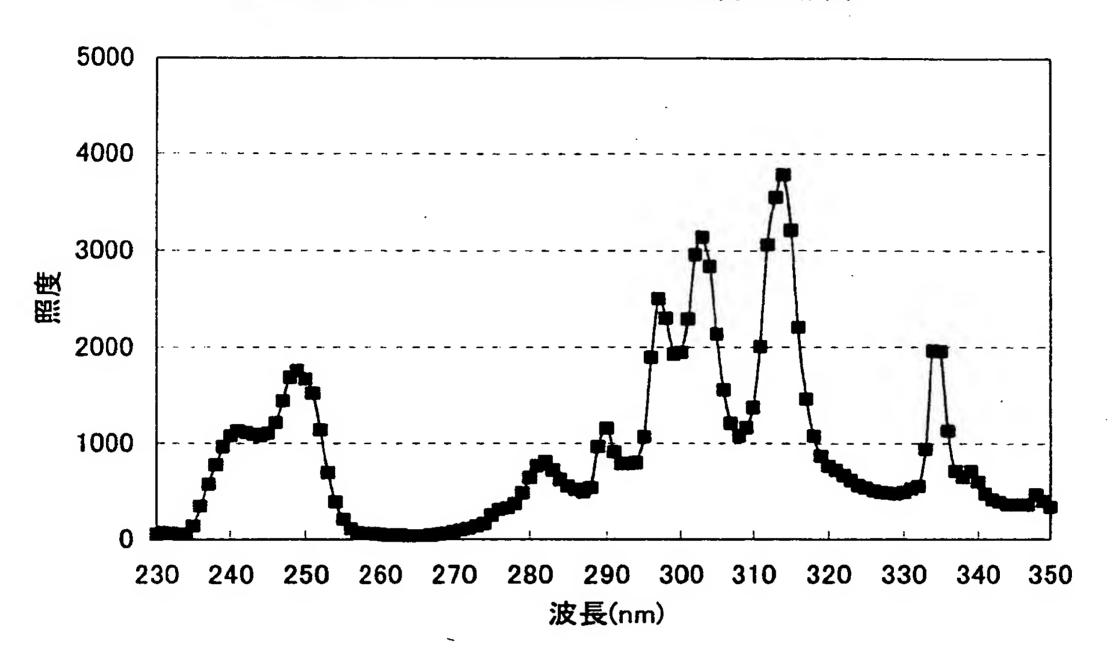
【図4】 カットフィルターを用いた露光機(UX-3000SC)の波長と照度との相関



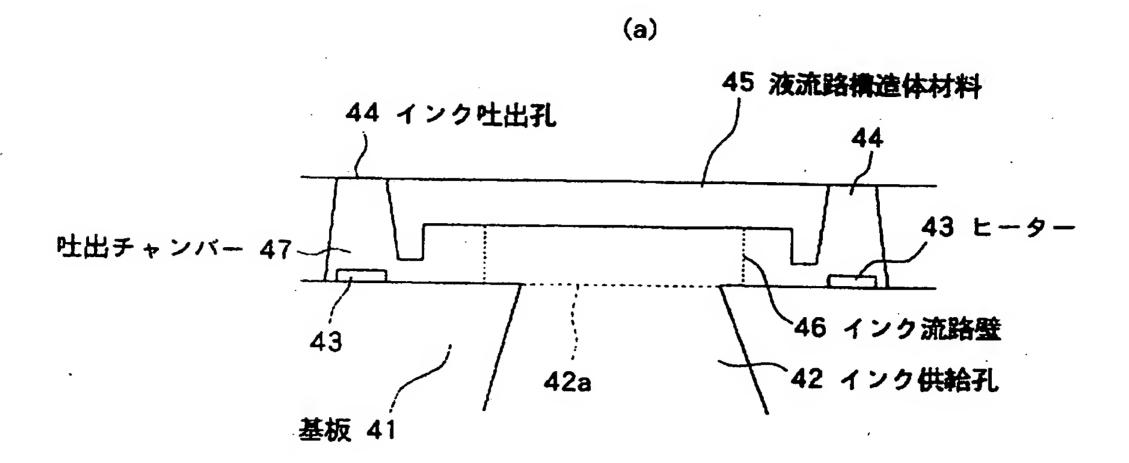
ページ:

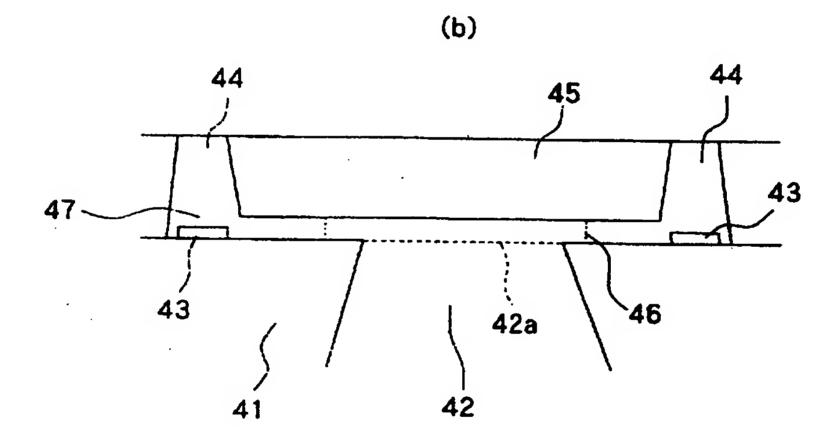
【図5】

露光機(UX-3000SC)の波長と照度との相関

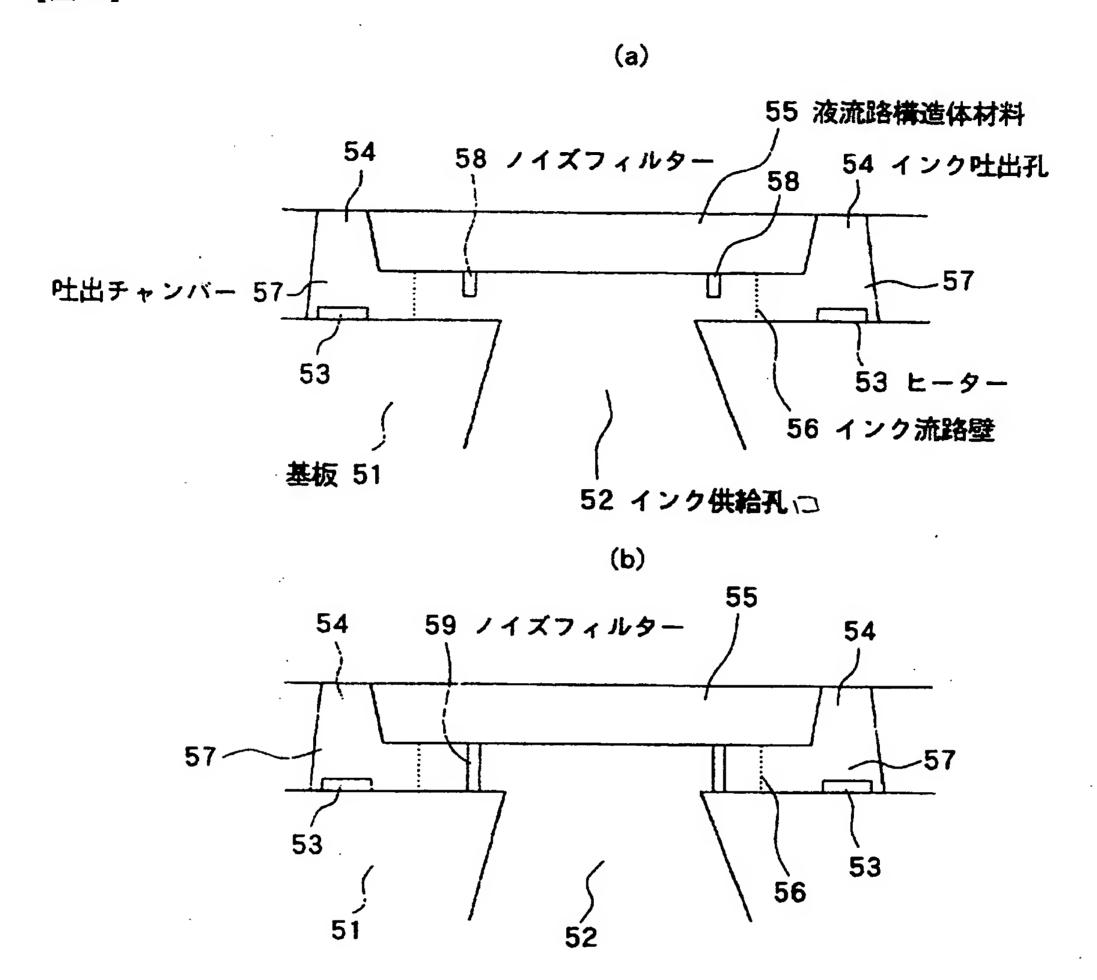


【図6】

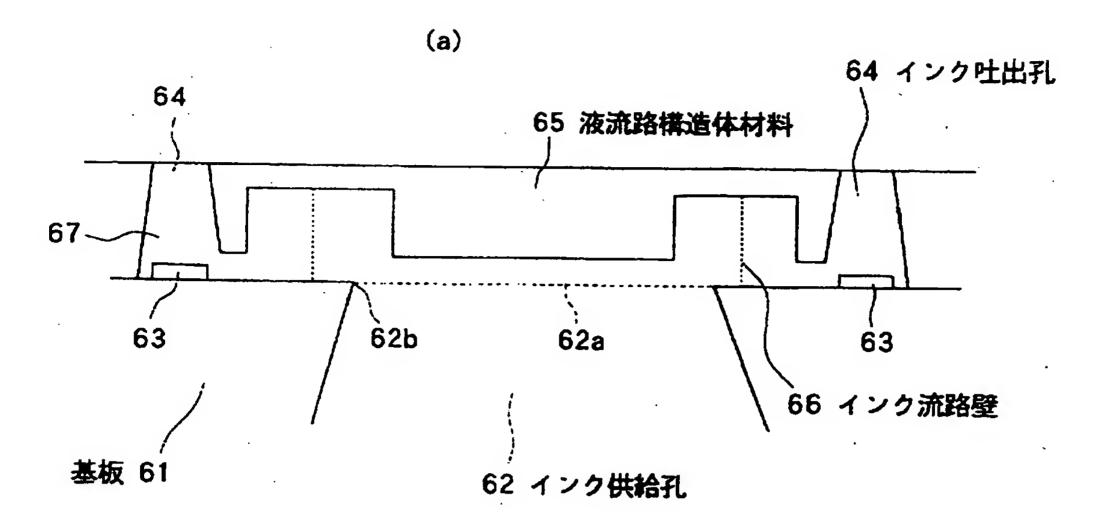


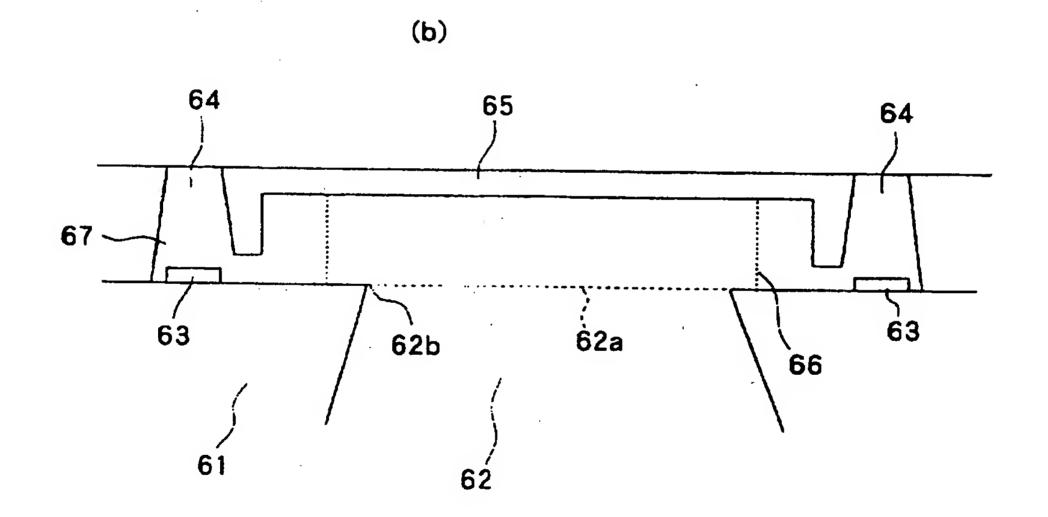


【図7】

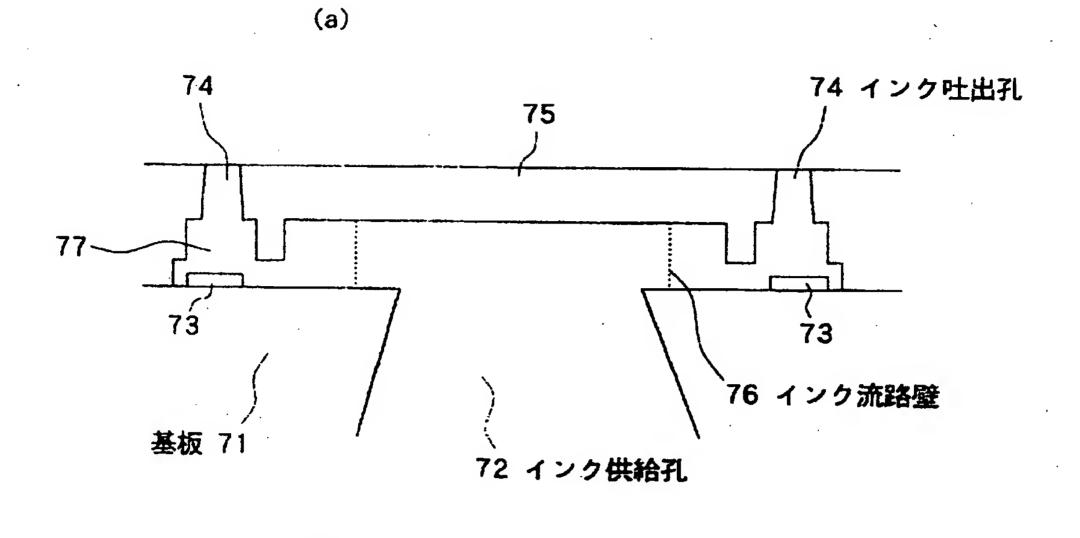


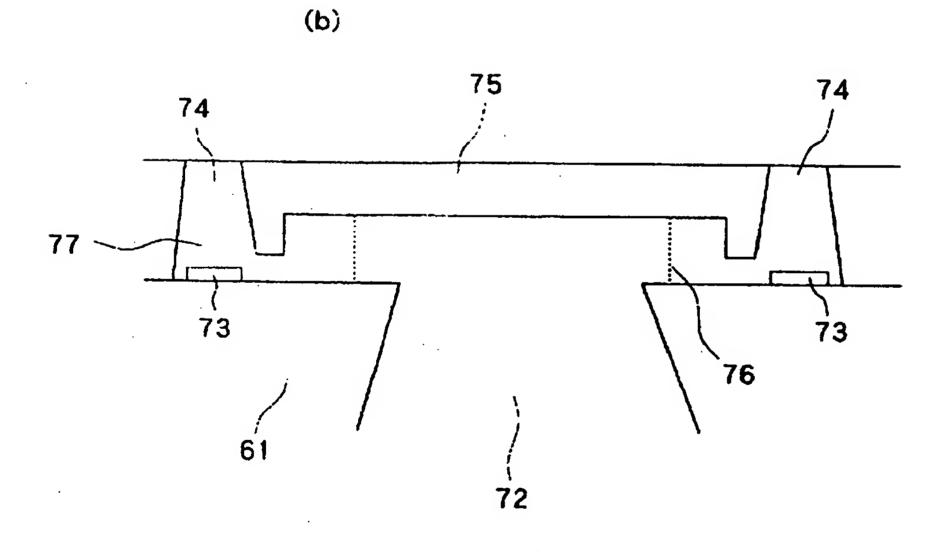
[図8]



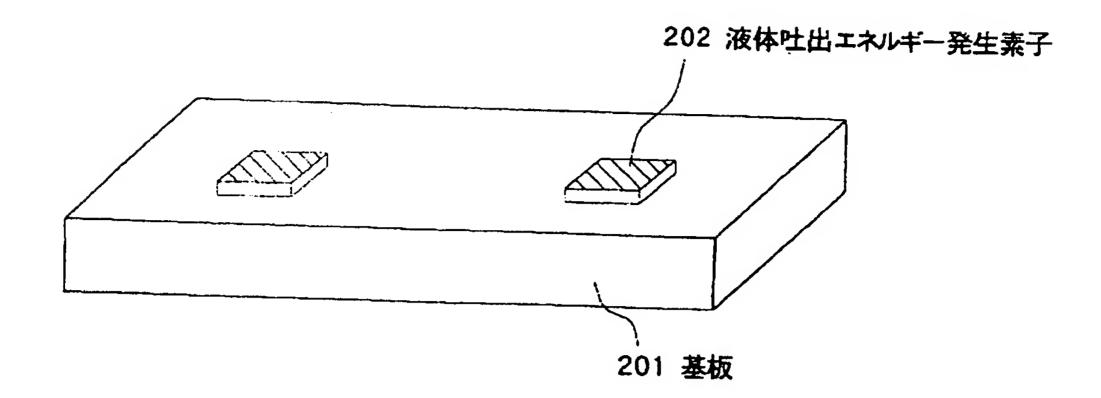


【図9】

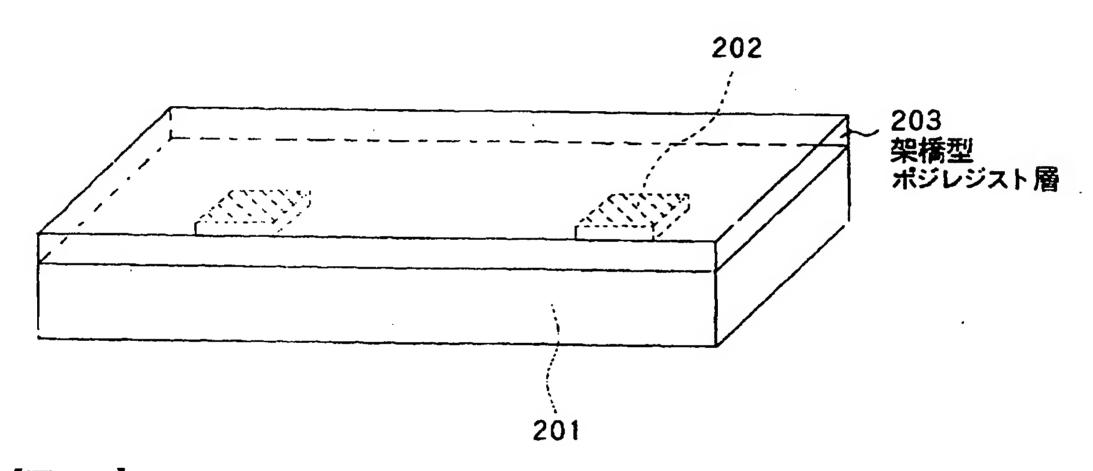




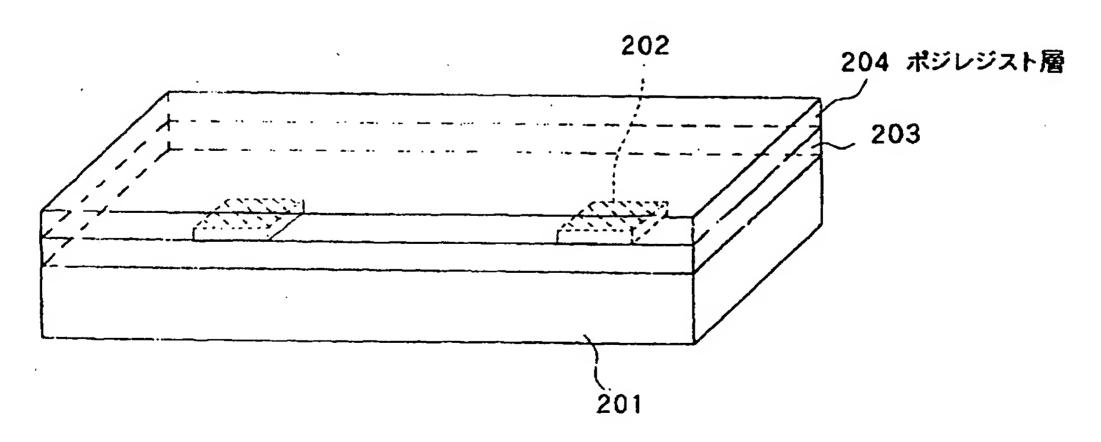
【図10】



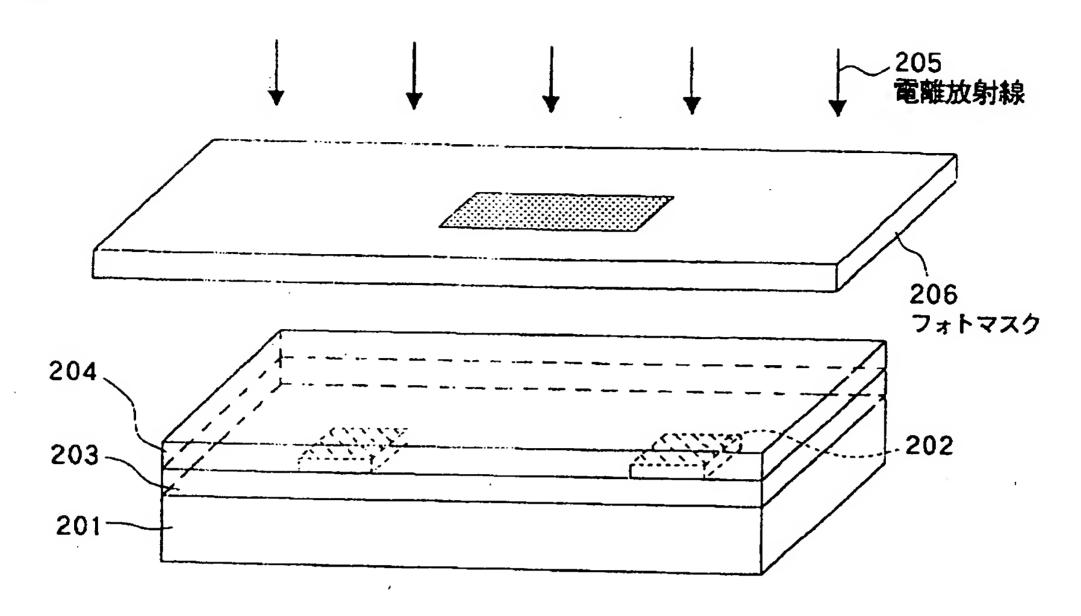
【図11】



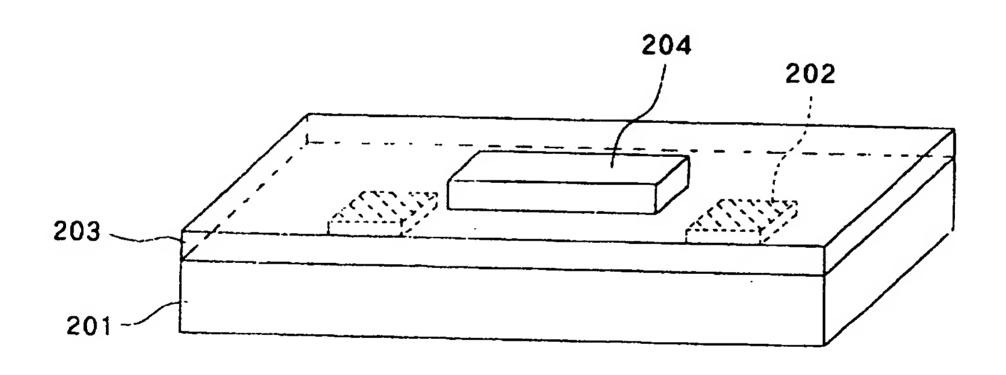
[図12]



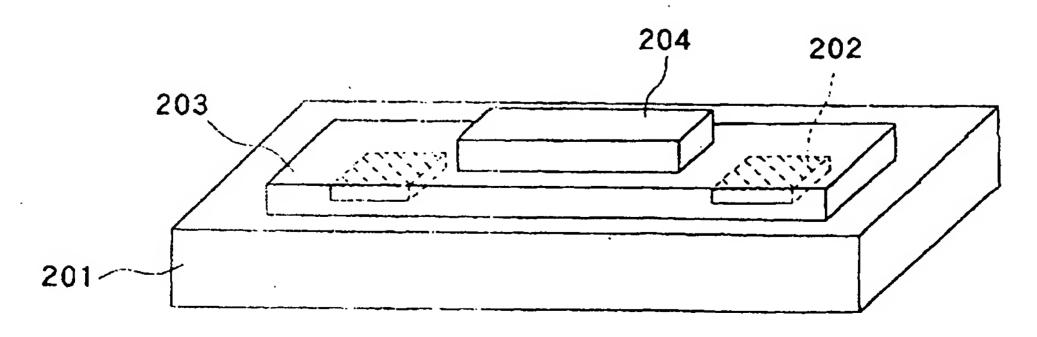
【図13】



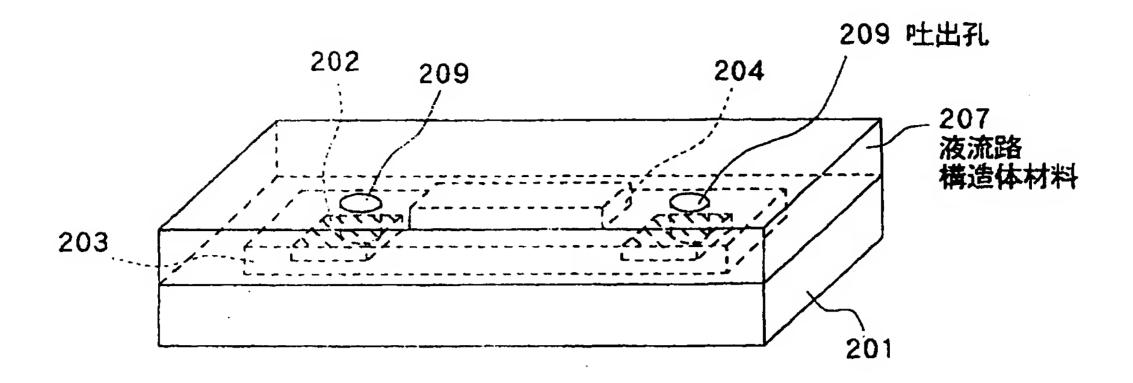
【図14】



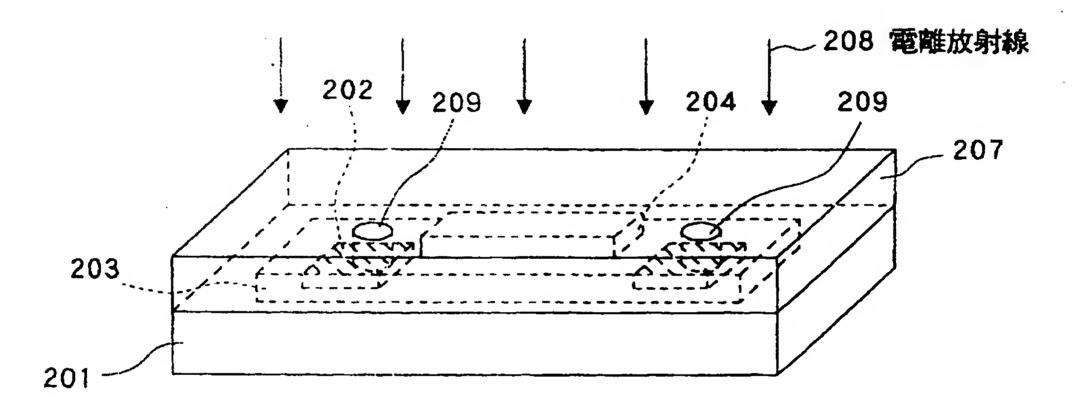
【図15】



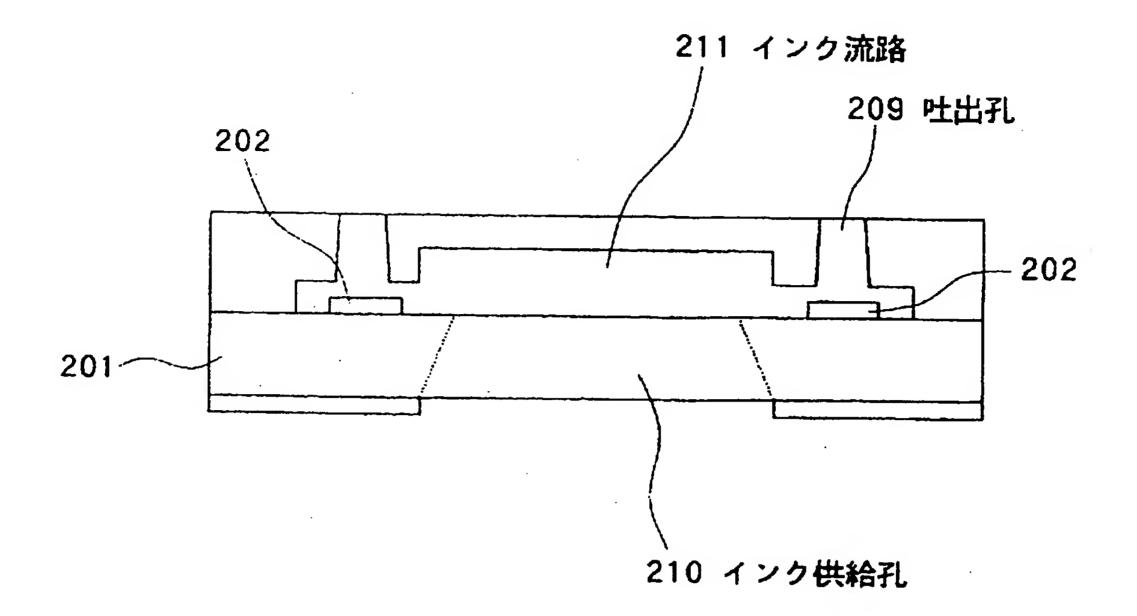
【図16】



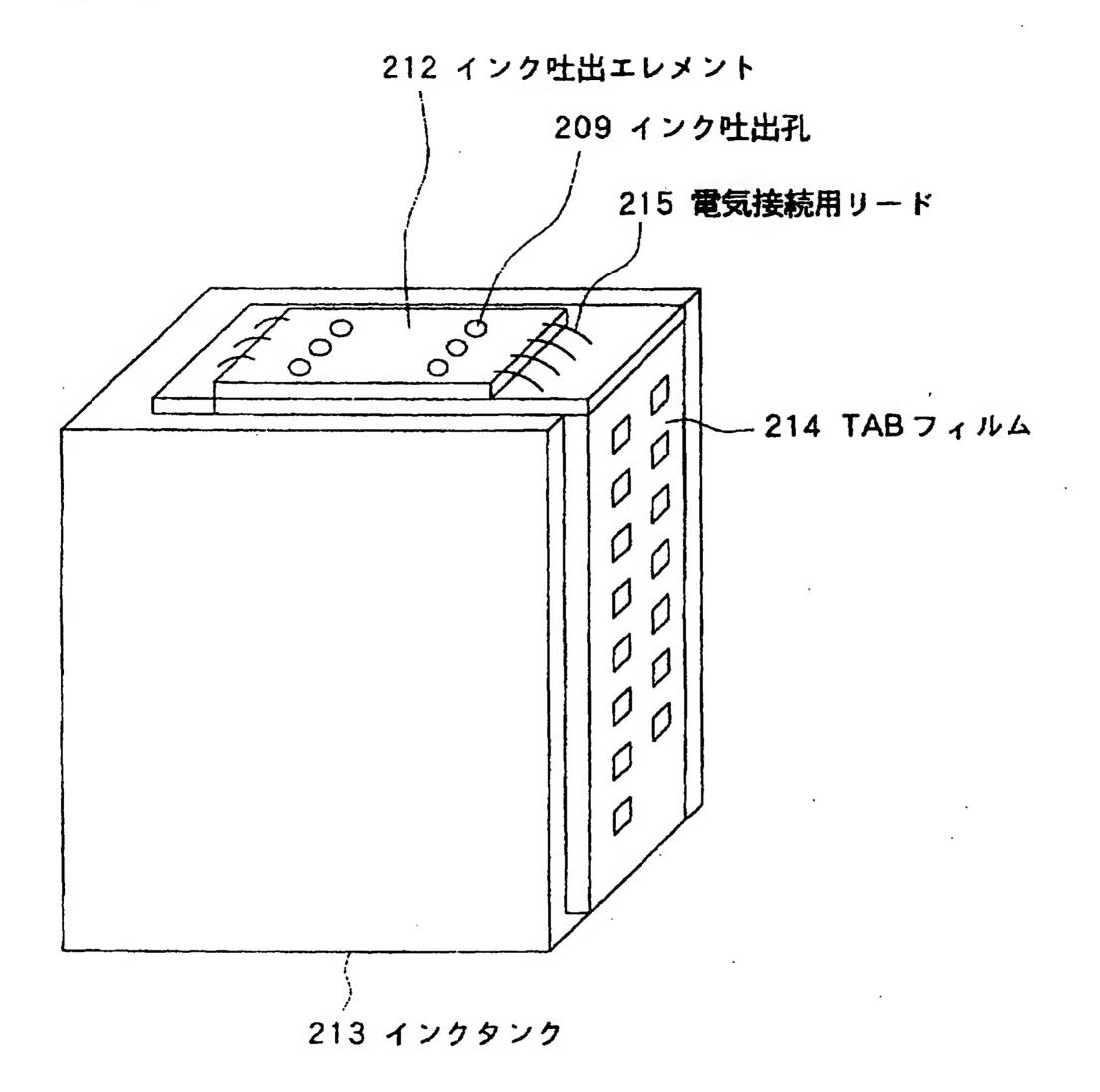
【図17】



【図18】



【図19】



【図20】

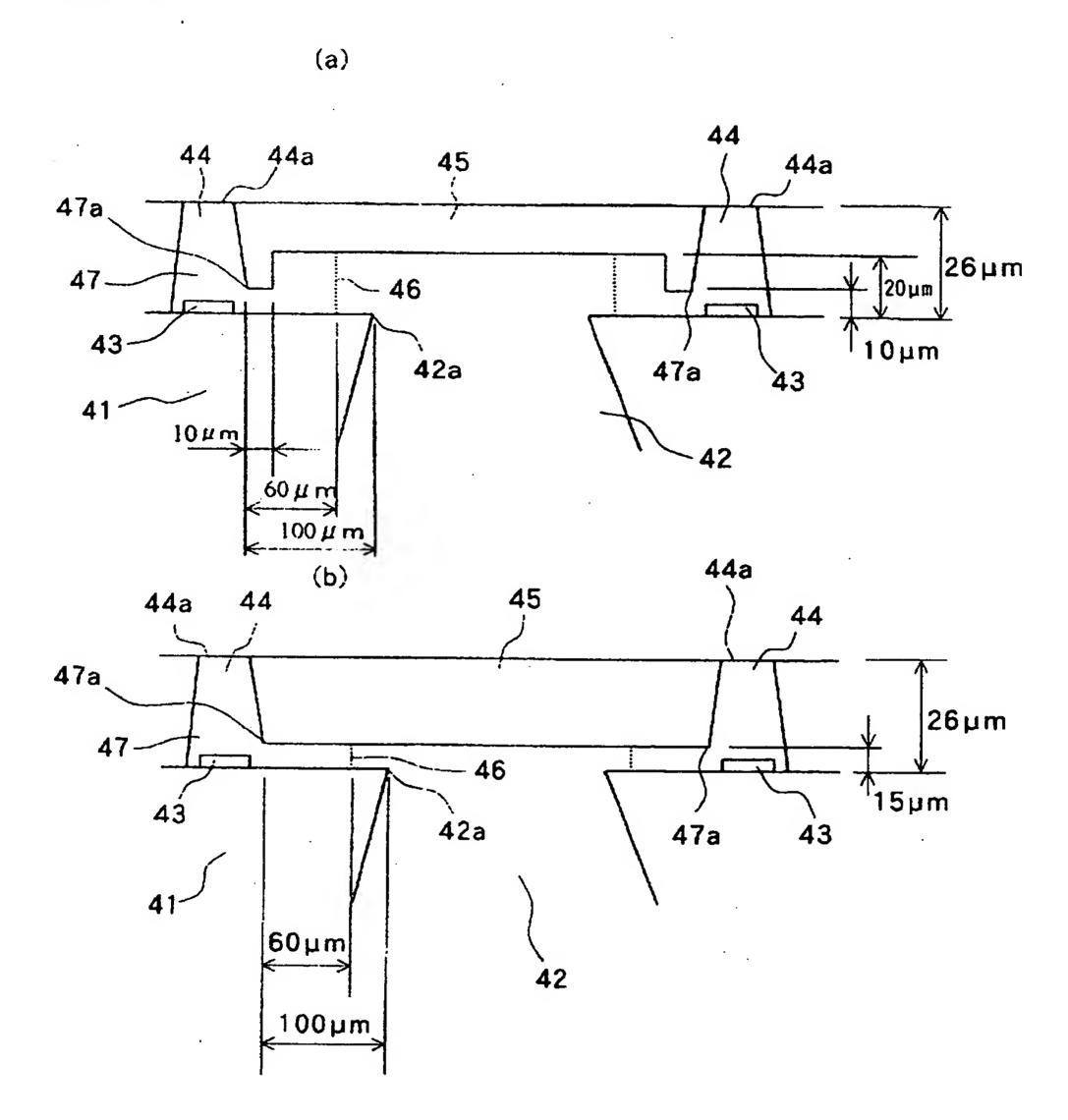
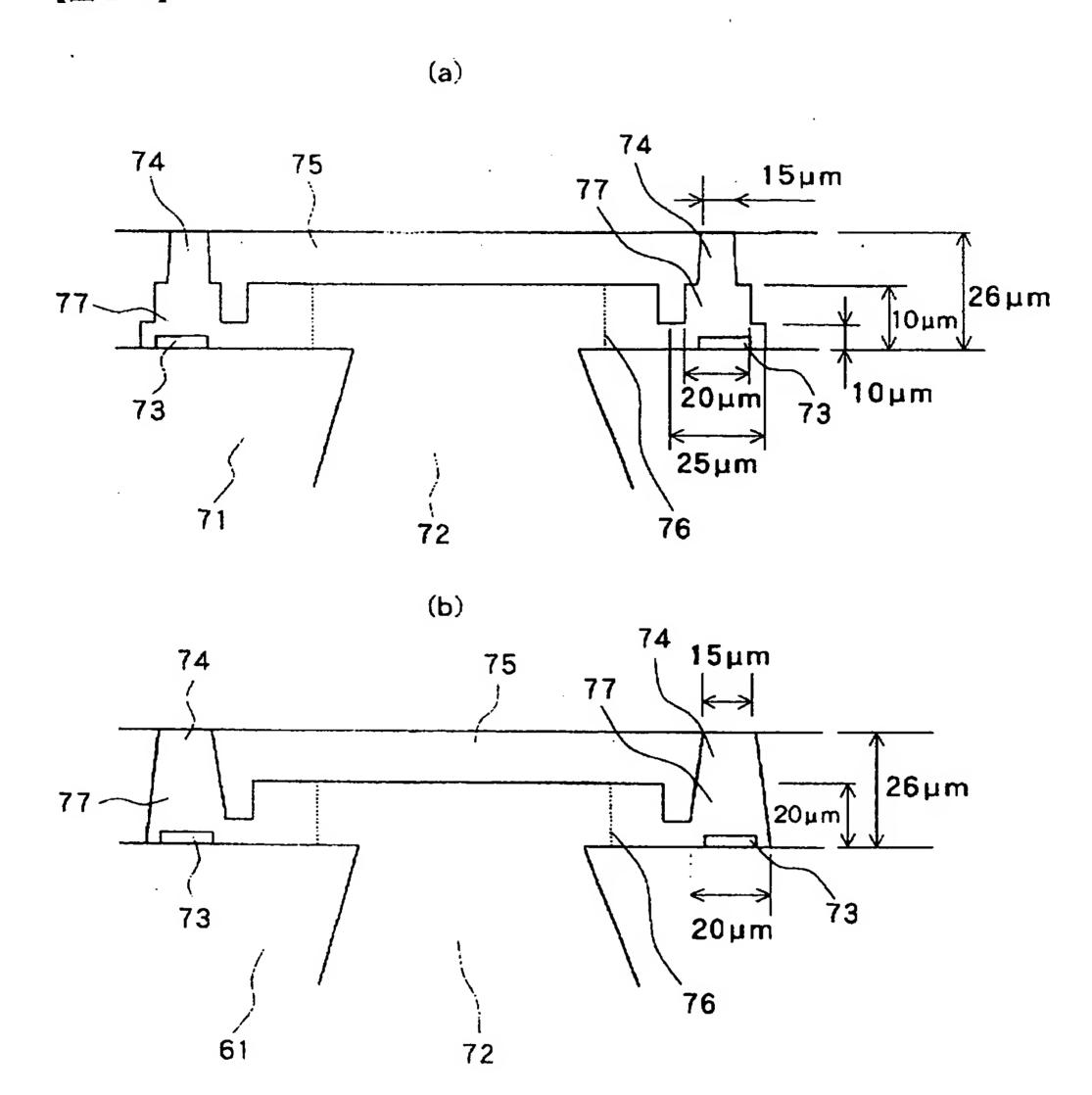
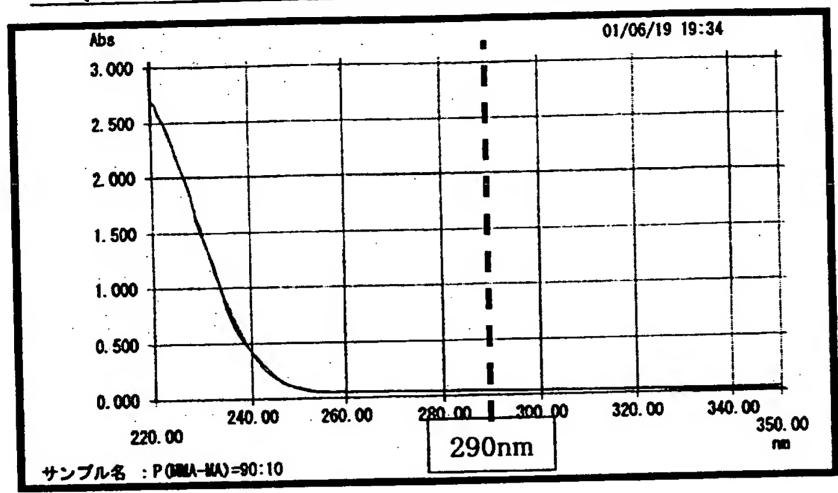


図21

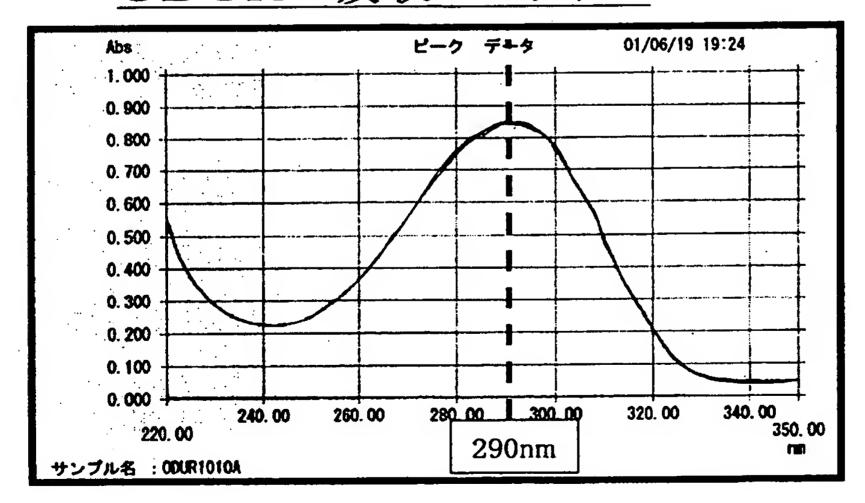


【図22】

P(MMA-MAA)の吸収スペクトル



PMIPK ODURの吸収スペクトル



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 安価、精密であり、また信頼性も高い液体吐出ヘッド及び該ヘッドの 製造方法を提供すること。

【解決手段】 基板上に、熱架橋したポジ型感光性材料層(第1のポジ型感光材料層)と第2のポジ型感光性材料層を形成し、まず、第2のポジ型感光性材料層にパターンを形成した後、第1のポジ型感光性材料層にパターンを形成する。ついで、その上に流路壁を形成するネガ型樹脂を積層し、吐出孔を該ネガ型樹脂層に形成した後ポジ型感光材料層を除去する。この際に、第1のポジ型感光材料として、メタクリル酸単位が2~30重量%であり、分子量5000~5000であるメタクリル酸を含むメタクリル系共重合体組成物とする電離放射線分解型ポジレジストとし、第2のポジ型感光性材料層が、ポリメチルイソプロペニルケトンを主成分とする電離放射線分解型ポジレジストとすることで達成される。

【選択図】 図1

特願2002-201805

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

変更年月日
 変更理由]

1990年 8月30日 新規登録

住所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キヤノン株式会社